

内容

1 特性	1	8.2 功能方框图	18
2 应用	1	8.3 器件功能模式	19
3 说明	1	8.4 工作模式	19
4 器件选项	3	8.5 特性说明	20
5 引脚配置和功能	4	9 应用和实施	37
6 规格	5	9.1 应用信息	37
6.1 绝对最大额定值.....	5	9.2 典型应用	37
6.2 ESD 等级.....	5	9.3 电源相关建议	39
6.3 建议运行条件.....	5	9.4 布局	40
6.4 热性能信息.....	6	10 器件和文档支持	43
6.5 电气特性.....	6	10.1 接收文档更新通知	43
6.6 SNS 时序特性.....	11	10.2 支持资源	43
6.7 开关特性.....	12	10.3 商标	43
6.8 典型特性.....	13	10.4 静电放电警告	43
7 参数测量信息	15	10.5 术语表	43
8 详细说明	17	11 修订历史记录	43
8.1 概述.....	17	12 机械、封装和可订购信息	43

4 器件选项

器件版本	器件型号	电流限制范围	用于电感负载的集成式钳位	浪涌电流周期
A	TPS281C100A ⁽¹⁾	1A 至 5A (ILIM 接地短路时固定为 0.5A)	是	是
B	TPS281C100B ⁽¹⁾	1A 至 5A (ILIM 接地短路时固定为 0.5A)	是	否

(1) 器件现可采用 DNT 封装。PWP 封装处于预发布状态。如需更多信息，请联系 TI。

5 引脚配置和功能

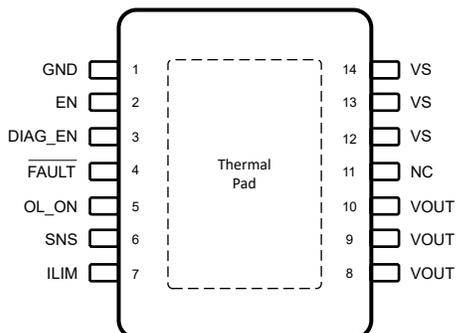


图 5-1. PWP 引脚，14 引脚 HTSSOP (顶视图)

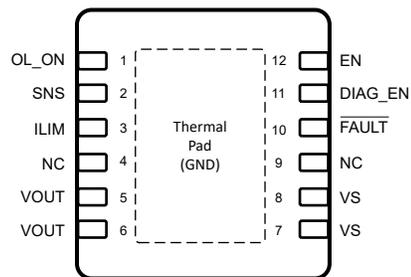


图 5-2. DNT 封装，12 引脚 WSON (顶视图)

表 5-1. 引脚功能

名称	引脚		类型	说明
	PWP	DNT		
GND	1	Pad	电源	器件地。连接到电阻器-二极管接地网络，以提供反极性保护。
EN	2	12	I	通道激活的输入控制。内部下拉电阻。
DIAG_EN	3	11	I	用于诊断和电流检测的启用/禁用引脚。内部下拉电阻。
FAULT	4	10	O	开漏全局故障输出。以 \overline{FLT} 为基准，或故障引脚。低电平有效信号。
OL_ON	5	1	I	用于更高分辨率电流检测的启用-禁用引脚（仅当 $I_{OUT} < I_{Ksns2_EN}$ 时才可用）。内部下拉电阻。
SNS	6	2	O	与负载电流对应的模拟电流输出。将电阻器连接到 GND 以转换为电压。
ILIM	7	3	O	可调节电流限制。连接一个电阻器以设置电流限制。可选择接地短路或使引脚悬空，以将电流限制设置为默认内部电流限制。有关更多信息，请参阅电气特性。
NC	11	4、9	不适用	无内部连接。
VOUT	8、9、10	5、6	电源	高侧开关的输出，连接至负载。
VS	12、13、14	7、8	电源	电源输入。
Pad	散热焊盘	Pad	—	散热焊盘，内部接地短路。

未使用引脚的推荐连接

TPS281C100x 旨在提供一组增强的诊断和保护特性。然而，如果系统设计仅允许使用有限数量的 I/O 连接，则某些引脚可能会被视为可选引脚。

表 5-2. 可选引脚的连接

引脚名称	未使用时的连接	未使用时的影响
SNS	通过 10k Ω 电阻器接地	模拟检测不可用。
ILIM	浮点	如果 ILIM 引脚悬空，器件将设置为默认的内部限制阈值。
FAULT	浮点	如果 \overline{FAULT} 引脚未使用，则系统无法从输出端读取故障。
DIAG_EN	悬空或通过 R_{PROT} 电阻器接地	如果 DIAG_EN 未使用，则模拟检测、开路负载和电源短路诊断不可用。
OL_ON	通过 R_{PROT} 电阻器接地	未使用 OL_ON 时，高精度检测模式不可用。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

	最小值	最大值	单位
连续电源电压, V_S 以 IC GND 为基准: 版本 A、B	-0.7	64	V
连续电源电压, V_{OUT} 以 IC GND 为基准: 版本 A、B	-60	64	V
电源引脚上的瞬态 (< 100 μ s) 电压, V_S 以 IC GND 为基准: 版本 A、B	-0.7	81	V
使能引脚电压, V_{EN}	-1	6	V
OL_ON 引脚电压, V_{OL_ON}	-1	6	V
DIAG_EN 引脚电压, V_{DIAG_EN}	-1	6	V
检测引脚电压, V_{SNS}	-1	6	V
FAULT 引脚电压, V_{FAULT}	-1	6	V
反向接地电流, I_{GND}	$V_S < 0V$		-50 mA
最大结温, T_J		150	°C
贮存温度, T_{stg}	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值的运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能会影响器件的可靠性、功能和性能, 并缩短器件的寿命。

6.2 ESD 等级

			值	单位	
V_{ESD}	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	除 VS 和 VOUT 外的所有引脚	± 2000	V
		人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	VS 和 VOUT, 以 GND 为基准	± 4000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 ⁽²⁾	所有引脚	± 750	V
$V_{(ESD4)}$	静电放电	接触放电, 符合 IEC 61000-4-2 ⁽³⁾	VS 和 VOUT	± 8000	V
$V_{(EFT)}$	静电放电	电气快速瞬态, 符合 IEC 61000-4-4 ⁽³⁾	VS 和 VOUT	± 2000	V
$V_{(surge)}$	静电放电	使用 42 Ω 实现浪涌保护, 符合 IEC 61000-4-5; 1.2/50 μ s ⁽⁴⁾	VS 和 VOUT	± 1000	V

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
 (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
 (3) 使用应用电路和 24V 电源电压 (VS)、ENx 引脚高电平 (启用输出) 和 EN 引脚低电平 (禁用输出) 进行了测试。
 (4) 使用应用电路和 24V 电源电压 (VS)、ENx 引脚高电平 (启用输出) 和 EN 引脚低电平 (禁用输出) 进行了测试。在 VS 和 VOUT 处需要外部 TVS。请参阅 IEC 61000-4-5 浪涌部分。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
$V_{S_OP_NOM}$	标称电源电压 ⁽¹⁾	6.0	60	V
V_{EN}	使能电压	-1	5.5	V
V_{OL_ON}	OL_ON 引脚电压, V_{OL_ON}	-1	5.5	V
V_{DIAG_EN}	诊断使能电压	-1	5.5	V
V_{FAULT}	FAULT 引脚电压	-1	5.5	V

6.3 建议运行条件 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _{SNS}	检测电压	-1	5.5	V
T _A	自然通风条件下的工作温度范围	-40	125	°C

(1) 所有工作电压条件均以器件 GND 为基准进行测量

6.4 热性能信息

热指标 ^{(1) (2)}		TPS281C100x		单位
		DNT (WSON)	PWP (HTSSOP)	
		12 引脚	14 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	36.9	TBD	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	24.4	TBD	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	13.7	TBD	°C/W
ψ _{JT}	结至顶部特征参数	0.4	TBD	°C/W
ψ _{JB}	结至电路板特征参数	13.7	TBD	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳 (底部) 热阻	1.1	TBD	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。

(2) 热参数基于符合 JESD51-5 和 JESD51-7 标准的 4 层 PCB。

6.5 电气特性

V_S = 6V 至 60V, T_J = -40°C 至 150°C (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
VS 电源电压和电流							
I _{L,NOM}	持续负载电流	V _{EN} = HI	T _{AMB} = 85°C	4.5			A
I _{IDLE, VS}	禁用诊断时的总器件空闲状态电流 (包括 MOSFET)	V _S ≤ 60V, V _{EN} = V _{DIAG_EN} = LO, V _{OUT} = 0V	T _J = -40°C 至 85°C	1	1.3		mA
			T _J = 150°C			1.5	mA
I _{IDLE, VS_DIAG}	启用诊断时的 V _S 待机空闲状态电流	V _S ≤ 60V, V _{EN} = LO, V _{DIAG_EN} = HI, V _{OUT} = 0V		1.2	1.7		mA
I _{Q, VS}	禁用诊断时的 V _S 静态电流	V _{EN} = HI, V _{DIAG_EN} = LO	I _{OUT} = 0A	0.98	1.3		mA
I _{Q, VS_DIAG}	启用诊断时的 V _S 静态电流	V _{ENx} = HI, V _{DIAG_EN} = HI	I _{OUT} = 0A	1.2	1.5		mA
I _{OUT(OFF)}	输出泄漏电流	V _S ≤ 60V, V _{EN} = 0V, R _{load} = 100k				0.4	μA
I _{OUT(OFF, SIN K)}	输出灌电流	V _S ≤ 60V, V _{EN} = 0V, V _{OUT} = 24V, V _{DIAG} = 0V	T _J = -40°C 至 85°C	2.1	2.8		mA
			T _J = 150°C	2.3	2.6		mA
V _{OUT(OFF)}	输出浮动电压	V _S ≤ 60V, V _{EN} = 0V, V _{OUT} 悬空, V _{DIAG} = 0V	T _J = -40°C 至 85°C			0.9	V
			T _J = 150°C			0.9	V
VS 欠压锁定 (UVLO) 输入							
V _{S,UVLOR}	V _S 欠压锁定上升	以器件的 GND 引脚为基准测得		5.0	5.4	5.75	V
V _{S,UVLOF}	V _S 欠压锁定下降	以器件的 GND 引脚为基准测得		4.1	4.5	4.85	V

6.5 电气特性 (续)

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$ (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
VDS 钳位							
$V_{DS,Clamp}$	V_{DS} 钳位电压	FET 电流 = 10mA	$V_S = 24V$	64	75	81	V
			$V_S = 6V$	48	53	58	V
RON 特性							
R_{ON}	导通电阻 (包括 MOSFET 和封装)	$0.5A \leq I_{OUT} \leq 3A, V_S = 6V$ 至 $60V$	$T_J = 25^\circ C$	83			$m\Omega$
R_{ON}	导通电阻 (包括 MOSFET 和封装)	$0.5A \leq I_{OUT} \leq 3A, V_S = 6V$ 至 $60V$	$T_J = 125^\circ C$	168			$m\Omega$
			$T_J = 150^\circ C$	180			$m\Omega$
$R_{ON(REV)}$	反极性期间的导通电阻	$0.5A \leq I_{OUT} \leq 3A, V_S = -24V$	$T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$	180			$m\Omega$
R_{ON_AUX}	V_S 至 V_{OUT} 导通电阻 高精度检测模式	$V_S = 24V, I_{OUT} = 40mA$ $OL_ON=DIAG_EN=5V$	$T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$	4.7	12		Ω
电流限制特性							
K_{CL}	电流限制比		$I_{CL, typ} = 5.26A$	52.6			$A \times k\Omega$
			$I_{CL, typ} = 4.15A$	51.9			$A \times k\Omega$
			$I_{CL, typ} = 3.04A$	50.8			$A \times k\Omega$
			$I_{CL, typ} = 1.98A$	49.5			$A \times k\Omega$
			$I_{CL, typ} = 0.96A$	48			$A \times k\Omega$
$I_{LIM_STARTUP}$	启用开关时的峰值电流限制 (A 版本)		$R_{ILIM} = 10k\Omega$ 至 $50k\Omega$	$2 \times I_{CL}$	6.5		A)
$t_{LIM_STARTUP_DELAY}$	器件保持在 $I_{LIM_STARTUP}$ 电平的延迟时间 (A 版本)			12		ms	
I_{CL}	电流限制电平	短路条件, $V_{DS} = 1V$	$R_{ILIM} = 50k\Omega$	0.73	0.96	1.11	A
			$R_{ILIM} = 25k\Omega$	1.5	1.98	2.3	A
			$R_{ILIM} = 16.7k\Omega$	2.3	3.04	3.5	A
			$R_{ILIM} = 12.5k\Omega$	3.15	4.15	4.77	A
			$R_{ILIM} = 10k\Omega$	4	5.26	6.3	A
			$R_{ILIM} = GND$ 、开路或超出范围 ($< 5k\Omega$ 和 $> 150k\Omega$)	0.35	0.48	0.6	A
I_{CL_LINPK}	过流限制阈值 ⁽¹⁾	过载条件	$R_{ILIM} = 25k\Omega$	$1.5 \times I_{CL}$			A
I_{CL_ENPS}	峰值电流可导致永久短路		$R_{ILIM} = 50k\Omega$	$4 \times I_{CL}$			A
			$R_{ILIM} = 25k\Omega$	$3.3 \times I_{CL}$			A
			R_{ILIM} 接地短路	$5.7 \times I_{CL}$			A
I_{CL_ENPS2}	峰值电流可导致永久短路		$R_{ILIM} = 10k\Omega, t < t_{LIM_STARTUP_DELAY}$	$2 \times I_{LIM_STARTUP}$			A
t_{IOS}	短路响应时间	$V_S = 24V$		0.5		μs	
热关断特性							
T_{ABS}	热关断			165	185		$^\circ C$
T_{REL}	相对热关断			77			$^\circ C$
t_{RETRY}	重试时间 ⁽²⁾	从故障关断到开关重新启用的时间 (热关断)。			2		ms
故障响应	针对热关断的故障响应				自动重试		

6.5 电气特性 (续)

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$ (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
T_{HYS}	绝对热关断迟滞			10			$^\circ C$
故障引脚特性							
V_{FAULT}	\overline{FAULT} 低输出电压	$I_{FAULT} = 2.5mA$		0.5			V
$t_{FAULT_BLAN_KING}$	启动期间的故障消隐时间 (A 和 B 版本)			$V_{DIAG_EN} = 5V$, $V_{EN} = 0V$ 至 $5V$			ms
t_{FAULT_FLT}	故障指示时间	故障和 \overline{FAULT} 置为有效之间的时间		75			μs
t_{FAULT_SNS}	故障指示时间	$V_{DIAG_EN} = 5V$ 故障与 I_{SNS} 稳定在 V_{SNSFH} 之间的时间		106			μs
电流检测特性							
I_{KSNS2_EN}	在 K_{SNS} 模式下时支持启用 K_{SNS2} 的负载电流	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$, $V_{OL_ON} = GND$		21	25	30	mA
I_{KSNS2_DIS}	在 K_{SNS2} 模式下时加载电流以禁用 K_{SNS2}	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$, $V_{OL_ON} = GND$		75	85	105	mA
K_{SNS}	电流检测比 - 标准检测 I_{OUT}/I_{SNS}	$I_{OUT} = 1A$, $V_{OL_ON} = GND$		800			A/A
K_{SNS2}	电流检测比 - 高精度检测 I_{OUT}/I_{SNS}	$I_{OUT} = 20mA$, $V_{OL_ON} = 5V$		24			A/A
I_{SNS}	电流检测电流	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$, $V_{OL_ON} = GND$	$I_{OUT} = 4A$	5			mA
				-4	6		%
			$I_{OUT} = 3.5A$	4.375			mA
				-4	4		%
			$I_{OUT} = 3A$	3.75			mA
				-4	4		%
			$I_{OUT} = 2A$	2.5			mA
				-4	4		%
			$I_{OUT} = 1A$	1.25			mA
				-4	4		%
			$I_{OUT} = 0.75A$	0.9375			mA
				-6	6		%
			$I_{OUT} = 0.5A$	0.625			mA
				-6	6		%
$I_{OUT} = 250mA$	0.3125			mA			
	-10	10		%			
$I_{OUT} = 150mA$	0.1875			mA			
	-10	10		%			
$I_{OUT} = 60mA$	0.075			mA			
	-25	25		%			
$I_{OUT} = 30mA$	0.0375			mA			
	-25	25		%			

6.5 电气特性 (续)

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
I_{SNS2}	高精度检测模式的电流检测电流和精度	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$, $V_{OL_ON} = 5V$	$I_{OUT} = 20\text{ mA}$	0.833		mA	
				-6	6	%	
			$I_{OUT} = 10\text{ mA}$	0.404		mA	
				-10	10	%	
			$I_{OUT} = 4\text{ mA}$	0.161		mA	
				-12.5	12.5	%	
$I_{OUT} = 2\text{ mA}$	0.0800		mA				
	-15	15	%				
$I_{OUT} = 1\text{ mA}$	0.0395		mA				
	-20	20	%				
SNS 引脚特性							
V_{SNSFH}	V_{SNS} 故障高电平	$V_{DIAG_EN} = 5V$	4.5	5	5.77	V	
		$V_{DIAG_EN} = 3.3V$, R_{SNS} =开路	3.3	3.95	4.4	V	
		$V_{DIAG_EN} = V_{IH}$	2.9	3.2	3.5	V	
I_{SNSFLT}	I_{SNS} 故障高电平	$V_{DIAG_EN} > V_{IH,DIAG_EN}$	5.2	6.4		mA	
$I_{SNSleak}$	I_{SNS} 漏电流	$V_{DIAG_EN} = 5V$, $I_L = 0\text{ mA}$			1.3	μA	
V_{S_ISNS}	完整的电流检测和故障功能所需的 V_S 余量	$V_{DIAG_EN} = 3.3V$	5.9			V	
		$V_{DIAG_EN} = 5V$	6.7			V	
开路负载检测特性							
V_{OL_OFF}	关断状态开路负载 (OL) 检测电压	$V_{EN} = 0V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$	1.4	2	2.5	V	
R_{OL_OFF}	关断状态开路负载 (OL) 检测内部上拉电阻	$V_{EN} = 0V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$	$V_S = 6V$	110	125	135	$k\Omega$
			$V_S = 24V$	114	140	166	$k\Omega$
			$V_S = 48V$	120	140	166	$k\Omega$
t_{OL_OFF}	关断状态开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间	$V_{EN} = 0V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$, 当 $V_S - V_{OUT} < V_{OL}$ 时, 持续时间长于 t_{OL} 。检测到开路负载。		480	1050	μs	
$t_{OL_OFF_1}$	从 EN 下降开始的 OL_OFF 和 STB 指示时间	$V_{EN} = 5V$ 至 $0V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$ $I_{OUT} = 0\text{ mA}$, $V_{OUT} = V_S - V_{OL}$		310	905	μs	
$t_{OL_OFF_2}$	从 DIA_EN 上升开始的 OL 和 STB 指示时间	$V_{EN} = 0V$, $V_{DIAG_EN} = 0V$ 至 $5V$ $I_{OUT} = 0\text{ mA}$, $V_{OUT} = V_S - V_{OL}$			1080	μs	
OL_ON 引脚特性							
$V_{IL_OL_ON}$	输入电压低电平				0.8	V	
$V_{IH_OL_ON}$	输入电压高电平		1.5			V	
$V_{IHYS_OL_ON}$	输入电压迟滞			282		mV	
R_{OL_ON}	内部下拉电阻器		0.7	1	1.3	$M\Omega$	
$I_{IL_OL_ON}$	输入电流低电平	$V_{OL_ON} = -1V$	-25		0	μA	
$I_{IL_OL_ON}$	输入电流低电平	$V_{OL_ON} = 0.8V$	0.6	.8	1.2	μA	
$I_{IH_OL_ON}$	输入电流高电平	$V_{OL_ON} = 5V$	3	5	7	μA	
DIAG_EN 引脚特性							
$V_{IL_DIAG_EN}$	输入电压低电平	无接地网络			0.8	V	
$V_{IH_DIAG_EN}$	输入电压高电平	无接地网络	1.5			V	
$V_{IHYS_DIAG_EN}$	输入电压迟滞			275		mV	

6.5 电气特性 (续)

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
R_{DIAG_EN}	内部下拉电阻器		200	350	500	$k\Omega$
$I_{IL, DIAG_EN}$	输入电流低电平	$V_{DIAG_EN} = 0.8V$, $V_{EN}=0V$		2.9		μA
$I_{IH, DIAG_EN}$	输入电流高电平	$V_{DIAG_EN} = 5V$		14		μA
EN 引脚特性						
$V_{IL, EN}$	输入电压低电平	无接地网络			0.8	V
$V_{IH, EN}$	输入电压高电平	无接地网络	1.5			V
$V_{IHYS, EN}$	输入电压迟滞			280		mV
R_{EN}	内部下拉电阻器		200	350	500	$k\Omega$
$I_{IL, EN}$	输入电流低电平	$V_{EN} = 0.8V$		2.2		μA
$I_{IH, EN}$	输入电流高电平	$V_{EN} = 5V$		14		μA

- (1) 电流限制调节之前过载条件下的最大电流输出。
- (2) 数据未经量产测试。

6.6 SNS 时序特性

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $150^\circ C$ (除非另有说明), 参数未经量产测试

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
SNS 时序 - 电流检测						
$t_{SNSION1}$	从 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 V_{DIAG_EN} 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%	$V_{EN} = 5V$, $V_{DIAG_EN} = 0V$ 至 $5V$, $V_{OL_ON} = 0V$, $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 1A$			15	μs
		$V_{EN} = 5V$, $V_{DIAG_EN} = 0V$ 至 $5V$, $V_{OL_ON} = 0V$, $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 50mA$			80	μs
$t_{SNSION2}$	从 EN 和 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 V_{DIAG_EN} V_{EN} 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 0V$ 至 $5V$ $V_S = 24V$, $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 1A$			150	μs
$t_{SNSION3}$	从 EN 的上升沿开始的稳定时间 V_{EN} 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%	$V_{EN} = 0V$ 至 $5V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 1A$			150	μs
$t_{SNSION4}$	从 OL_ON 的上升沿开始的稳定时间 V_{OL_ON} 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%	$V_{OL_ON} = 0$ 至 $5V$, $V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 6mA$			60	μs
$t_{SNSION5}$	从 I_L 的下降沿 ($< I_{KSNS2_EN}$) 到稳定 ISNS 的 90% 的稳定时间	$V_{OL_ON} = V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 100mA$ 至 $10mA$			60	μs
$t_{SNSION6}$	从 I_L 的上升沿 ($> I_{KSNS2_DIS}$) 到稳定 ISNS 的 90% 的稳定时间	$V_{OL_ON} = V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 10mA$ 至 $100mA$			60	μs
$t_{KSNS2_DIS_DGL}$	I_L ($> I_{KSNS2_DIS}$) 转换的抗尖峰脉冲时间。	$V_{OL_ON} = V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_L = 10mA$ 至 $100mA$			30	μs
$t_{SNSIOFF}$	从 DIAG_EN 的下降沿开始的稳定时间	$V_{EN} = 5V$, $V_{DIAG_EN} = 5V$ 至 $0V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $R_L = 48\Omega$			20	μs
$t_{SETTLEH}$	从负载阶跃的上升沿开始的稳定时间。 V_{OL_ON} 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_{OUT} = 0.5A$ 至 $3A$			20	μs
$t_{SETTLEL}$	从负载阶跃的下降沿开始的稳定时间。 V_{OL_ON} 的 50% 到稳定 ISNS 的 10%	$V_{EN} = V_{DIAG_EN} = 5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_{OUT} = 3A$ 至 $0.5A$			20	μs
$t_{TIMEOUT}$	由于 $V_S - V_{OUT} > 2V$ 而指示 VSNSFH 的时间。 从 EN、DIAG_EN 和 OL_ON 的上升沿 V_{DIAG_EN} V_{EN} V_{OL_ON} 的 50% 到 VSNSFH 的上升沿的 50%	$V_{DIAG_EN} = V_{EN} = V_{OL_ON} = 0V$ 至 $5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_{OUT} = 5mA$ $C_{OUT} = 50\mu F$		245		μs
t_{SNSFH}	SNSFH 的置为有效时间 从 VSNSFH 上升沿的 50% 到 VSNSFH 下降沿的 50%	$V_{DIAG_EN} = V_{EN} = V_{OL_ON} = 0V$ 至 $5V$ $R_{SNS} = 1k\Omega$, $I_{OUT} = 5mA$ $C_{OUT} = 15\mu F$	60			μs

6.7 开关特性

$V_S = 6V$ 至 $60V$, $T_J = -40^\circ C$ 至 $+150^\circ C$ (除非另有说明), $C_{OUT} = 22nF$

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{DR}	导通延迟时间 (来自延迟或诊断)	$V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$ EN 的 50% 至 VOUT 的 20%		17	45	μs
t_{DF}	关断延迟时间	$V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$ EN 的 50% 至 VOUT 的 80%	10	18	26	μs
SR_R	VOUT 上升转换率	$V_S = 24V$, VOUT 的 20% 至 80%, $R_L = 48\ \Omega$	2.3	3.6	4.6	V/ μs
SR_F	VOUT 下降转换率	$V_S = 24V$, VOUT 的 80% 至 20%, $R_L = 48\ \Omega$	2.3	3.5	4.8	V/ μs
t_{ON}	开通时间	$V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$ EN 的 50% 至 VOUT 的 80%		20	40	μs
t_{OFF}	关断时间	$V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$ EN 的 50% 至 VOUT 的 20%		20	40	μs
$t_{ON} - t_{OFF}$	导通和关断匹配	1ms 导通时间开关使能脉冲 $V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$	-25		45	μs
Δ_{PWM}	PWM 精度 - 平均负载电流	200 μs 使能脉冲, $V_S = 24V$, $R_L = 48\ \Omega$ $F = f_{max}$	-15		15	%

6.8 典型特性

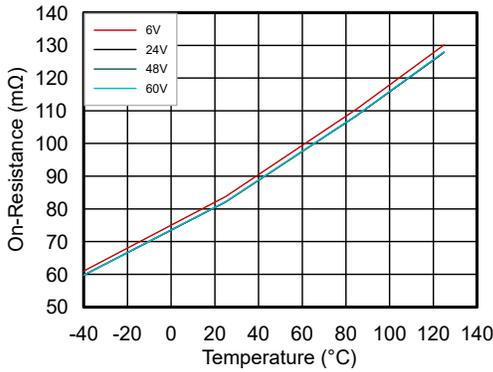


图 6-1. 导通电阻 (R_{ON}) 与温度与 VS 电源电压间的关系

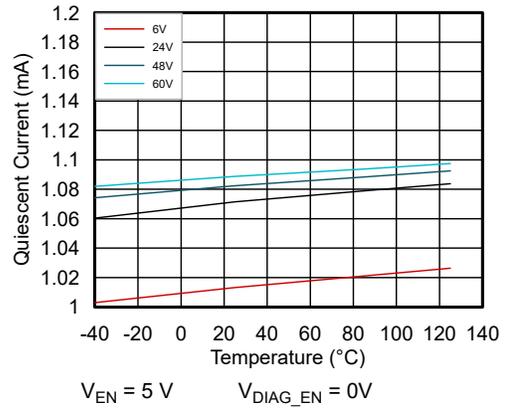


图 6-2. 来自 VS 输入电源的静态电流 ($I_{Q, vs}$) 与温度与 VS 电压间的关系
 $V_{EN} = 5V$ $V_{DIAG_EN} = 0V$

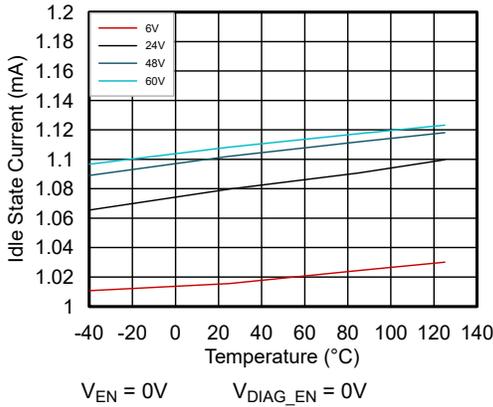


图 6-3. 来自 VS 输入电源的空闲状态电流 ($I_{idle, vs}$) 与温度与 VS 电压间的关系
 $V_{EN} = 0V$ $V_{DIAG_EN} = 0V$

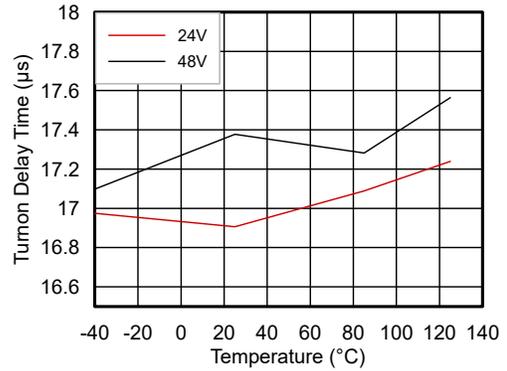


图 6-4. 导通延迟时间 (t_{DR}) 与温度与 VS 电压间的关系

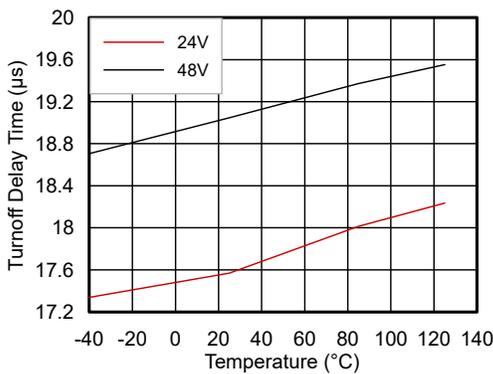


图 6-5. 关断延迟时间 (t_{DF}) 与温度与 VS 电压间的关系

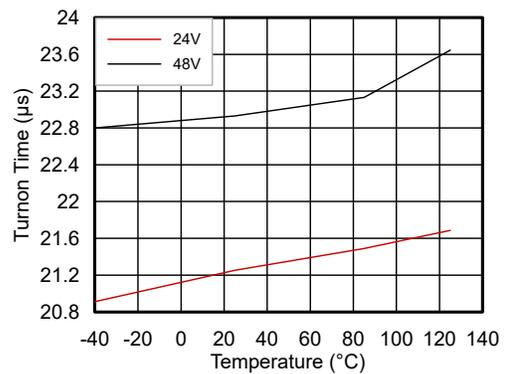


图 6-6. 开通时间 (t_{ON}) 与温度与 VS 电压间的关系

6.8 典型特性 (续)

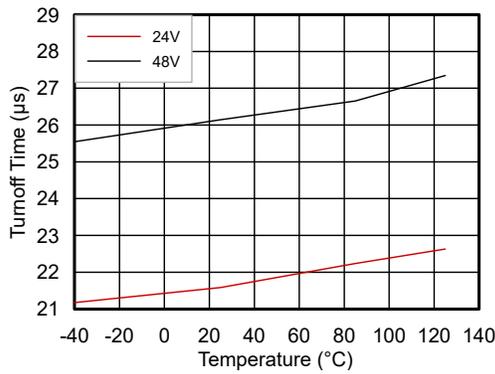


图 6-7. 关断时间 (t_{OFF}) 与温度与 VS 电压间的关系

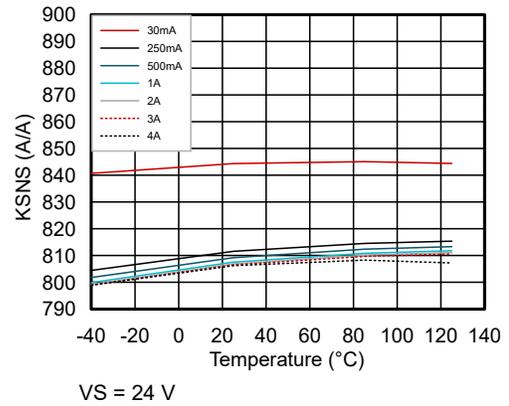


图 6-8. 电流检测比 (KSNS) 与温度和负载电流间的关系

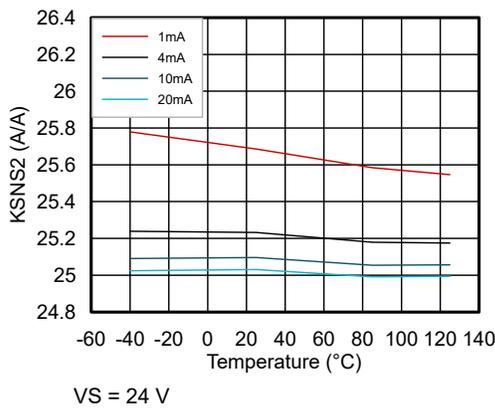


图 6-9. 电流检测比 (KSNS₂) 与温度与负载电流间的关系

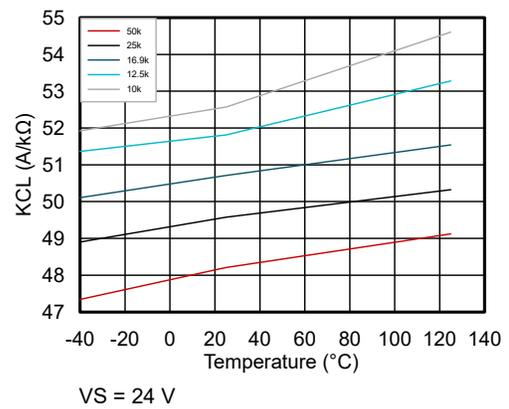


图 6-10. 电流限制比 (KCL) 与温度与 R_{LIM} 间的关系

7 参数测量信息

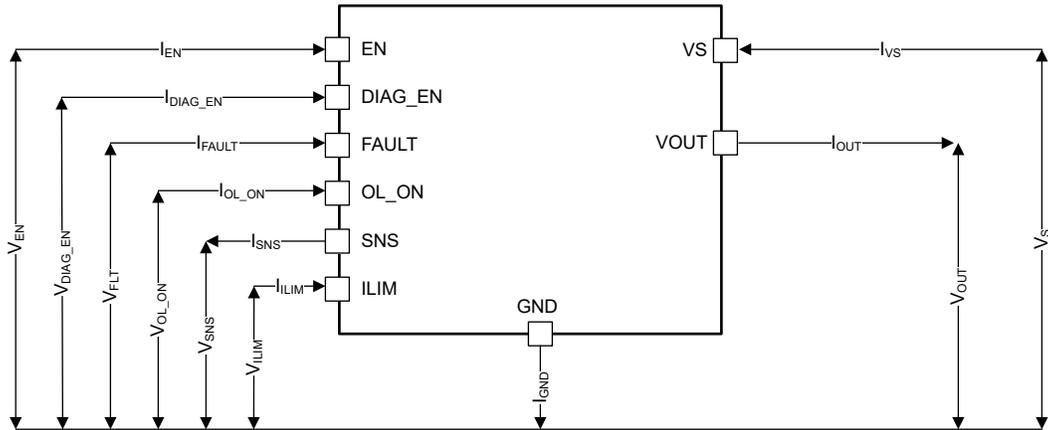
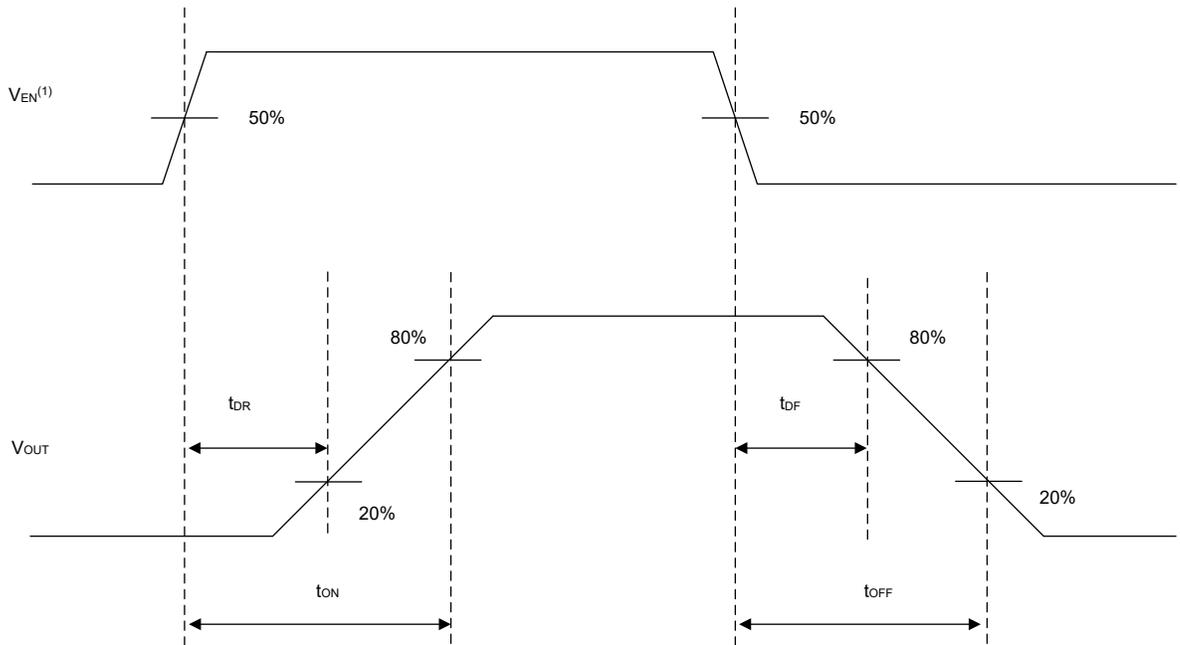
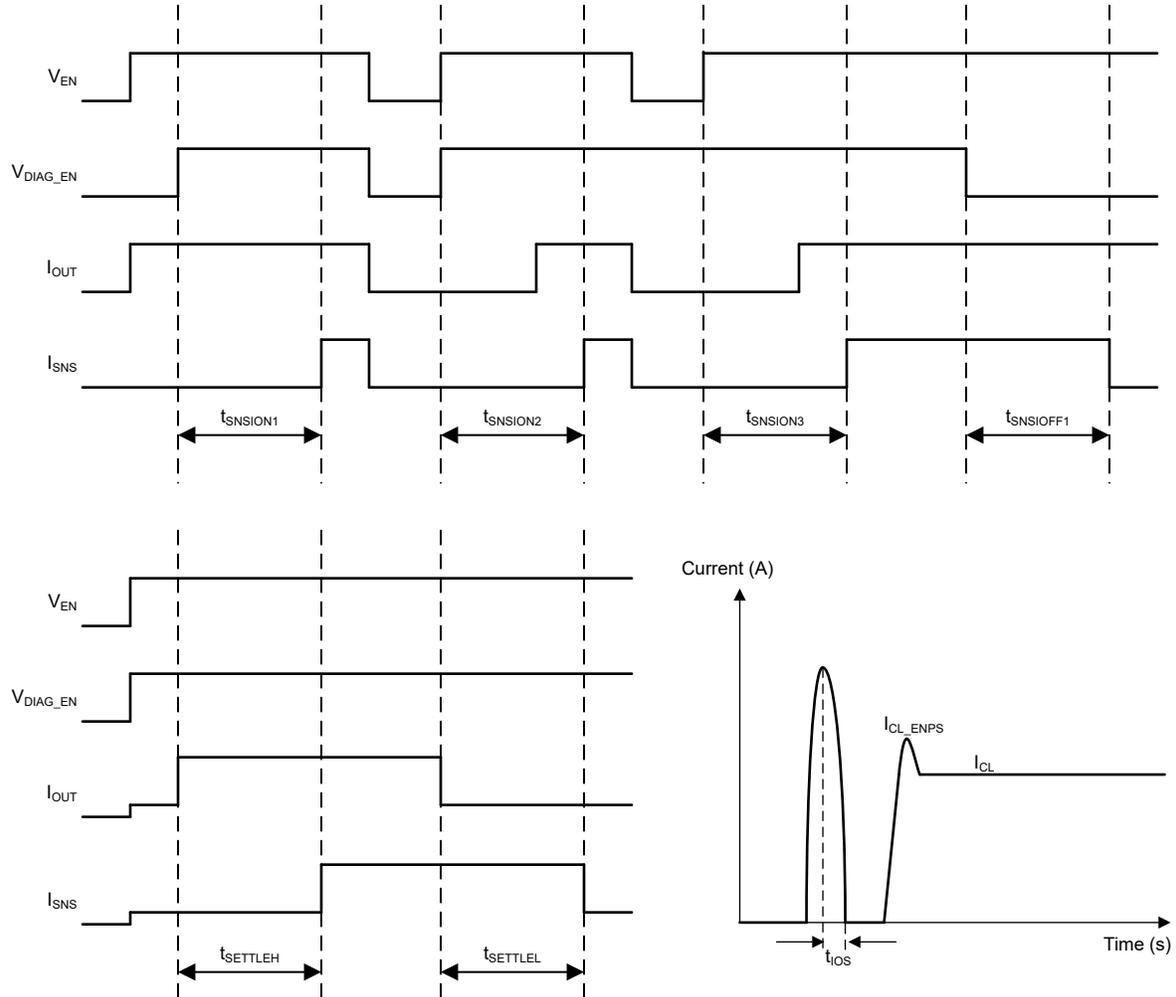


图 7-1. 参数定义



(1) V_{EN} 的上升和下降时间为 100ns。

图 7-2. 开关特性定义



控制信号的上升和下降时间为 100ns。控制信号包括：EN、DIA_EN。

图 7-3. SNS 时序特性定义

8 详细说明

8.1 概述

TPS281C100 是一款受到全面保护的单通道高侧电源开关，具有集成式 NMOS 电源 FET 和电荷泵。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测特性，能够对负载实施智能控制。输入引脚上的 1.5V 低逻辑高电平阈值 V_{IH} 允许使用低至 1.8V 的 MCU。可编程的电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告功能具有两个引脚来支持数字状态和模拟电流检测输出，当禁用诊断时，这两个引脚都可以设置为高阻抗状态，以便在器件间多路复用 MCU 模拟或数字接口。

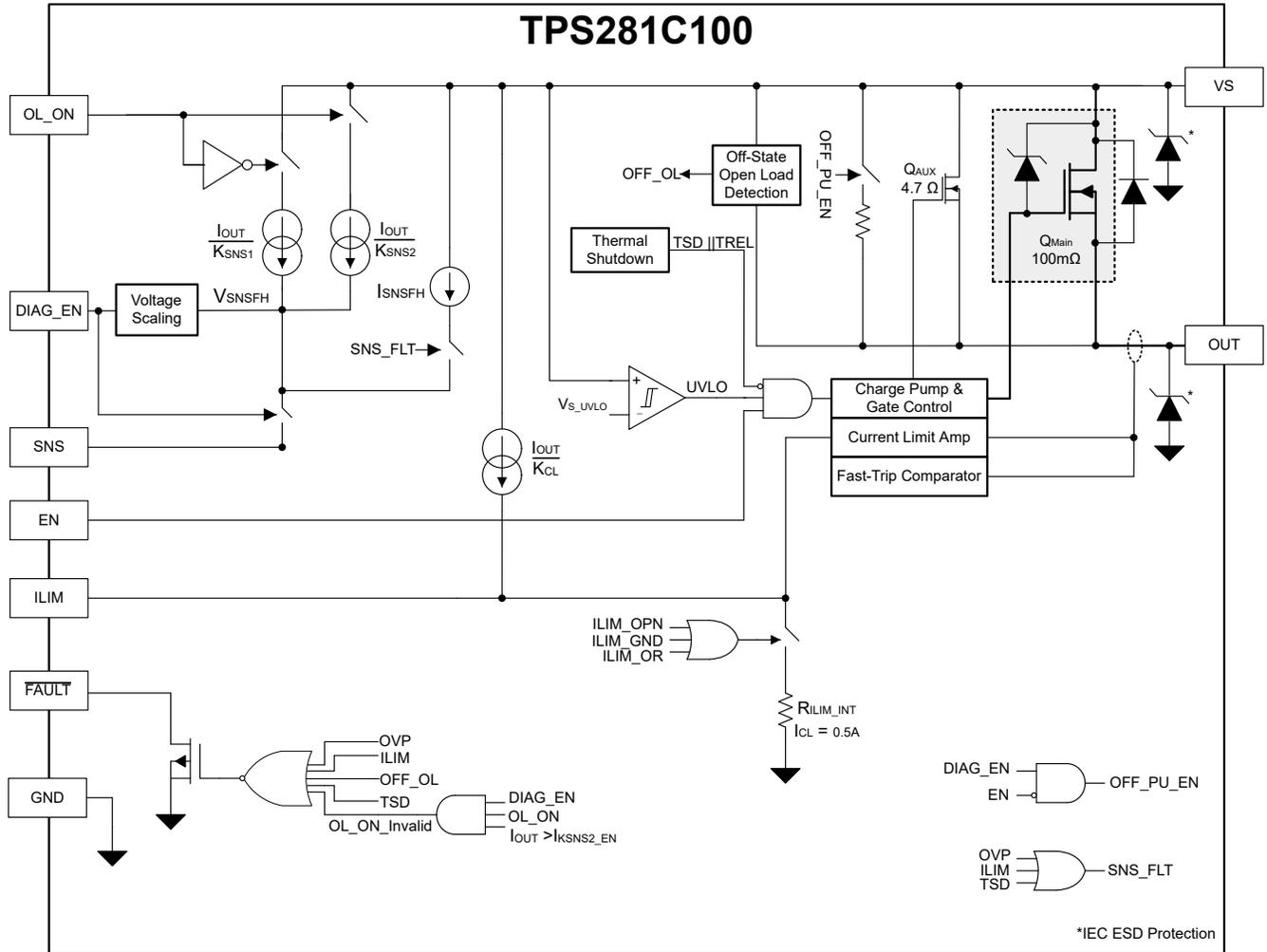
数字状态报告是在故障引脚上采用开漏结构实现的。当发生故障情况时，该引脚下拉至 GND。需要使用一个外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断，无需进一步校准。电流镜用于提供 $1/K_{SNS}$ 的负载电流，等于 SNS 引脚上的电压。 K_{SNS} 在整个温度和电源电压范围内是一个恒定值。SNS 引脚还可以通过强制 V_{SNSFH} 的电压来报告故障，该电压与诊断使能电压成比例，以便系统的 ADC 看到的最大电压在可接受的值内。这样，就无需在 SNS 引脚上使用外部齐纳二极管或电阻分压器。

外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。此功能通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流，极大地提高了系统的可靠性。此外，它还可以通过减少 PCB 走线、连接器尺寸和前一个功率级容量来节省系统成本。此器件中还可以实现内部电流限制。施加外部或内部电流限制值的较低值。

内置的有源漏源电压钳位可解决如继电器、螺线管、泵、电机等电感负载能量的关断问题。在电感关断周期期间，电源 (E_{BAT}) 和负载 (E_{LOAD}) 的能量都消耗在高侧电源开关本身上。凭借工艺技术和出色的 IC 布局的优势，TPS281C100x 器件可以实现出色的能量耗散能力，这在大多数情况下有助于省去外部续流电路。

TPS281C100x 器件可用作各种电阻负载、电感负载和容性负载（包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器）的高侧电源开关。

8.2 功能方框图



8.3 器件功能模式

8.4 工作模式

器件中的四种工作模式为正常模式、带诊断功能的正常模式、空闲模式和带诊断功能的空闲模式。

正常模式是 EN 为高电平而 DIAG_EN 为低电平时的模式。在此模式下，VS 的静态电流为 $I_{Q,VS}$ ，主 FET 导通。当 DIAG_EN 为低电平时，无法通过 SNS 引脚获得电流检测信息。

带诊断功能的正常模式是当 EN 和 DIAG_EN 均为高电平时的模式。在此模式下，VS 的静态电流为 I_{Q,VS_DIAG} ，主 FET 导通。当 DIAG_EN 为高电平时，可通过 SNS 引脚获取电流检测信息。

空闲模式是当 EN 和 DIAG_EN 均为低电平时的模式。在此模式下，主 FET 关断，VS 消耗 $I_{IDLE,VS}$ 的电流。由于 EFT 检测电路处于活动状态，因此与传统的关断状态相比，此状态会消耗额外的电流。此外，输出端有一个灌电流始终处于活动状态，以保持输出接近 0V。输出灌电流可高达 $I_{OUT(OFF,SINK)}$ 。

带诊断功能的空闲模式是当 EN 为低电平而 DIAG_EN 为高电平时的模式。在此模式下，主 FET 关断，VS 消耗 I_{IDLE,VS_DIAG} 的电流。当 DIAG_EN 为高电平时，输出上拉电路处于活动状态以实现开路负载和 VS 短路检测，并且不存在活动的输出灌电流。

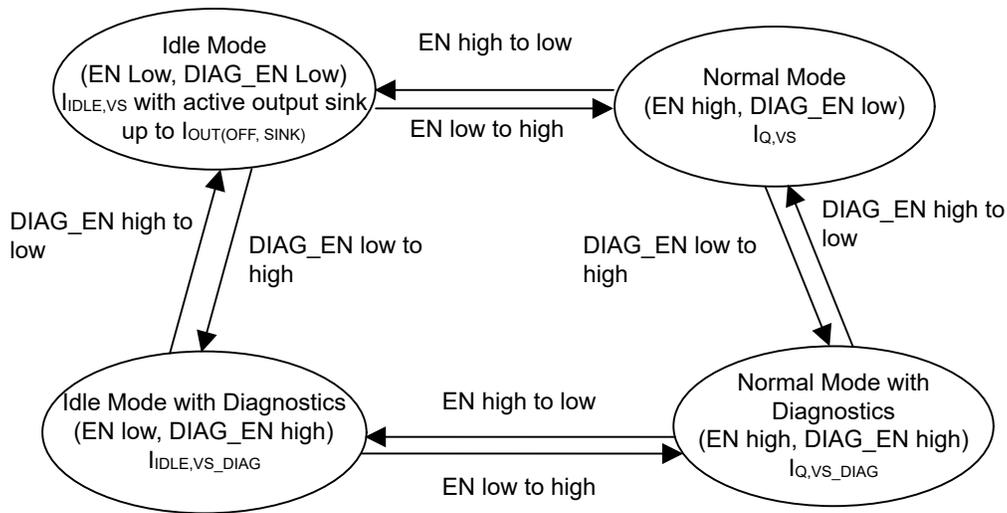


图 8-1. 工作模式状态机

8.5 特性说明

8.5.1 精确的电流检测

内部实现了电流检测功能，无需进一步校准，即可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断。电流镜用于提供 $1/K_{SNS}$ 的负载电流，流入 SNS 引脚和 GND 之间的外部电阻器，等于 SNS 引脚上的电压。

K_{SNS} 为输出电流与检测电流之比。电气特性中引用的 K_{SNS} 的精度值确实考虑了温度和电源电压。每个器件在生产时都经过内部校准，因此大多数情况下不需要用户进行后校准。

SNS 引脚上的最大输出电压被钳位至 V_{SNSFH} ，即故障电压电平。为了确保该电压不高于系统可以承受的电压，TI 已将进入 DIAG_EN 引脚的电压与 SNS 引脚上的最大电压输出相关联。如果 DIAG_EN 介于 V_{IH} 和 3.3V 之间，则 SNS 引脚上的最大输出将为 $\sim 3.3V$ 。但是，如果 DIAG_EN 上的电压高于 3.3V，则故障 SNS 电压 V_{SNSFH} 将跟踪该电压（高达 5V）。这样做是因为通过 DIAG_EN 为诊断供电的 GPIO 电压输出将接近同一微控制器内可接受的最大 ADC 电压。因此，可以选择检测电阻值 R_{SNS} ，以尽可能地扩大系统所需测量的电流范围。应根据应用需求选择 R_{SNS} 值。对于系统需要测量的最小负载电流 $I_{LOAD,min}$ ，最大可用 R_{SNS} 值受 ADC 最小可接受电压 $V_{ADC,min}$ 限制。可接受的最小 R_{SNS} 值必须确保 V_{SNS} 电压低于 V_{SNSFH} 值，以便系统可以确定故障。通过 SNS 引脚的最大可读电流 $I_{LOAD,max} \times R_{SNS}$ 与 V_{SNSFH} 之间的差值称为余量电压 V_{HR} 。余量电压由系统确定，但很重要，以便最大可读电流不触发故障情况。因此， R_{SNS} 的最小值必须是 V_{SNSFH} 与 V_{HR} 之差，乘以检测电流比 K_{SNS} ，然后除以系统需要测量的最大负载电流 $I_{LOAD,max}$ 。此边界公式如方程式 1 所示。

$$V_{ADC,min} \times K_{SNS} / I_{LOAD,min} \leq R_{SNS} \leq (V_{SNSFH} - V_{HR}) \times K_{SNS} / I_{LOAD,max} \quad (1)$$

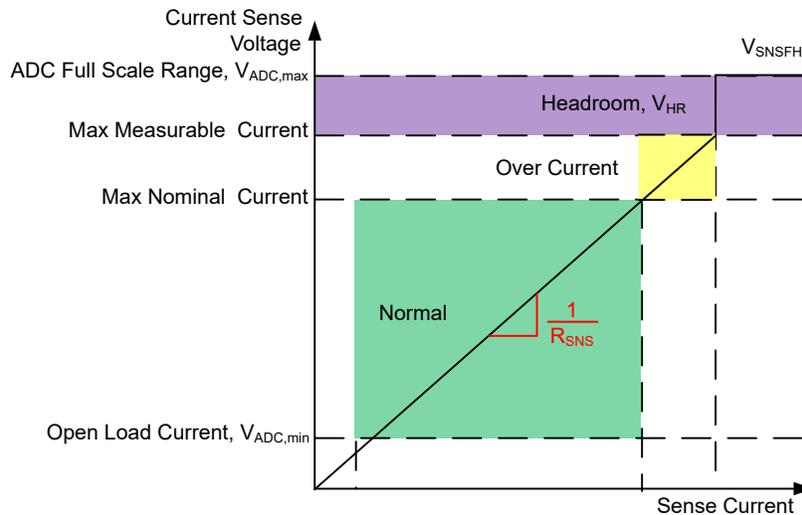


图 8-2. 电流检测引脚上的电压指示

系统要读取的最大电流 $I_{LOAD,max}$ 需要低于电流限制阈值，因为一旦电流限制阈值跳变， V_{SNS} 值将变为 V_{SNSFH} 。此外，测量中的电流应低于 4A，以确保电流检测输出不饱和。

8.5.1.1 高精度检测模式

在某些应用中，在较低负载电流下进行精确的电流检测对于区分实际负载和故障场景（如开路负载条件（断线））至关重要。为应对这一挑战，TPS281C100 实现了高精度检测模式，使客户能够在 4mA 负载下实现 $\pm 12.5\%$ 的精度。当启用诊断 (DIAG_EN=HI)、OL_ON = HI 且 $I_{Load} < I_{KSNS2_EN}$ 时，将激活此模式。为了实现这种高精度，该器件在高精度检测处于活动状态时增加其主路径电阻，以提高其检测精度。如果负载开始增加超过 20mA，TI 建议用户通过设置 OL_ON=LO 来禁用此精度检测模式。这将主动防止任何更高的功率耗散状态。

在其他情况下，例如突然的负载阶跃，此时系统可能无法足够快来对 SNS 输出电流的变化做出反应。对于这种情况，需要防止因电阻增加而出现高功率耗散状态。TPS281C100 检测到流经 VS 到 VOUT 路径的负载小于 I_{KSNS2_DIS} 。如果负载增加超过 I_{KSNS2_DIS} ，FET 电阻将恢复到其最低电阻，并且将禁用高精度检测模式。这将导致 FAULT 置为有效，以发出高精度检测模式已被禁用的信号。这将确保驱动更高负载时的功率耗散更低。除此之外，用户还可以对 OL_ON 引脚进行 PWM，以禁用高电阻模式并进一步更大限度地降低功率损耗。

但是，即使器件达到了精度，根据电流检测比，由于 ADC 需要读取的电压较低，系统 ADC 也可能难以准确地测量较低的负载电流。例如，使用 $RSNS=1k\Omega$ 且电流检测比为 800 时，6mA I_{Load} 将表示为 $\sim 7.5mV$ 。对于 10 位 5V ADC，7.5mV 输出略高于 1LSB (4.88mV)。这无法提供足够的裕量来准确测量 ADC 的这一电流，并且可能需要使用更高的分辨率。

因此，为满足较低的 ADC 分辨率要求并在高精度检测模式下运行时准确地检测低负载电流，TPS281C100 将其电流检测比降低至 24。如果检测比为 24 且在高精度检测模式下运行，则使用 $RSNS=1k\Omega$ 时，6mA I_{Load} 将表示为 250mV。对于相同的 10 位 ADC，这相当于 51LSB 的裕量，甚至对于 8 位 ADC，输出仍将提供 $> 12LSB$ 的余量。

针对完整器件状态的全面保护和诊断。

表 8-1. 电流检测运行模式

工作条件	EN	VOUT	OL_ON	KSNS	SNS	FAULT	行为	恢复
正常 标准检测	低电平	低电平	低电平	800	0	高阻态	正常	
	高电平	高电平	低电平	800	I_{Load}/K_{SNS}	高阻态	正常	
高精度检测 正常运行	高电平	高电平	高电平	24	I_{Load}/K_{SNS2}	高阻态	启用低检测比以实现高精度检测，并且由于满足有效条件 $I_{Load} < I_{KSNS2_EN}$ ，因此 FAULT 保持高阻抗。	
高精度检测 无效范围	高电平	高电平	高电平	800	I_{Load}/K_{SNS}	低电平	FAULT 置为有效表明由于 $I_{Load} > I_{KSNS2_DIS}$ 而未启用高精度检测	当负载降低至低于 I_{KSNS2_EN} 或 OL_ON 复位至 LO 时清除。

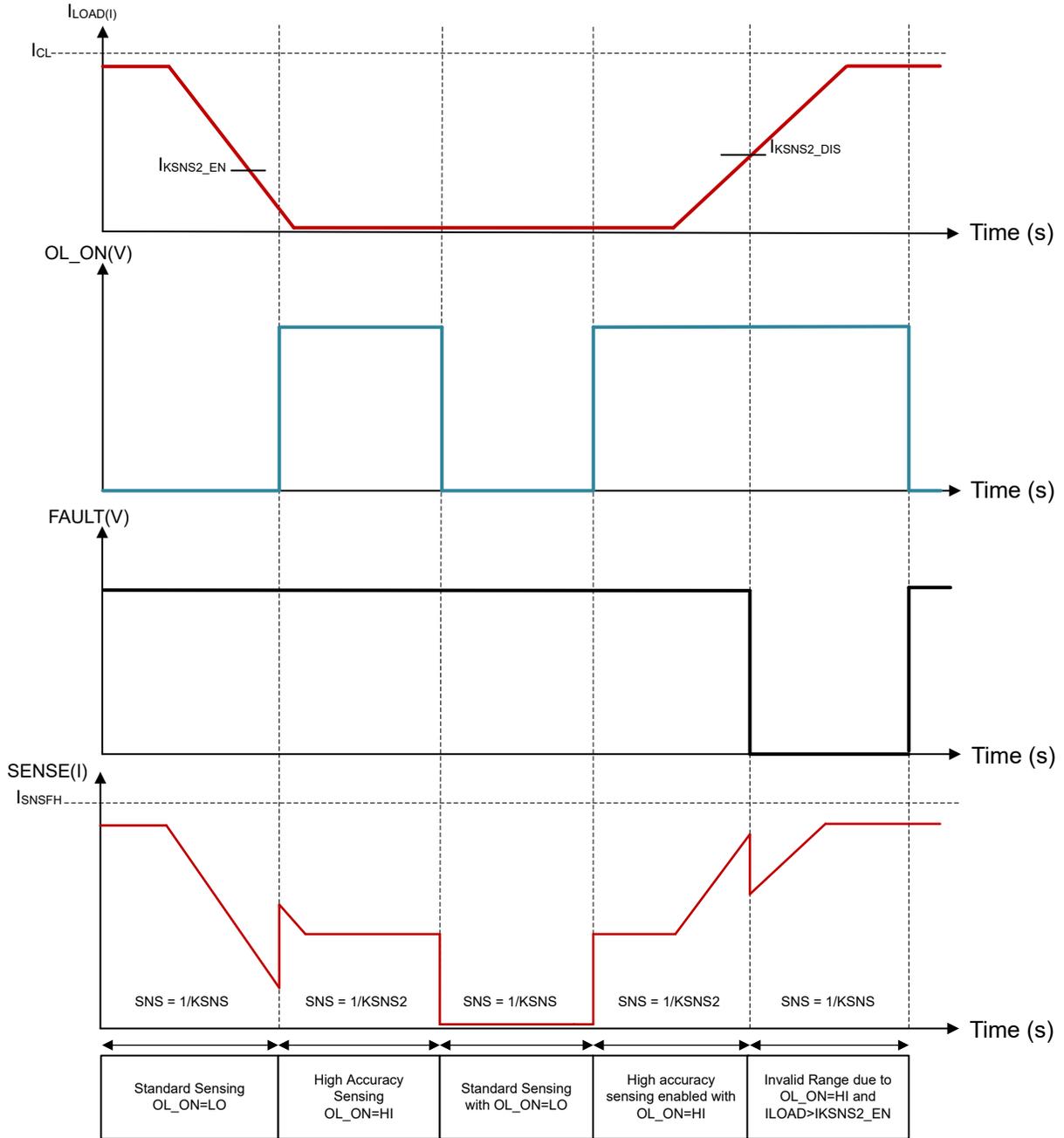


图 8-4. 高精度检测 FAULT 指示

8.5.2 可编程电流限制

高精度的电流限制可实现更高的可靠性，从而在短路或上电期间保护电源。此外，它还可以通过减少 PCB 走线、连接器尺寸和前一个功率级的容量来节省系统成本。

电流限制提供了保护功能，可防止负载和集成的功率 FET 出现过应力。电流限制将电流保持在设定值，将 SNS 引脚上拉至 V_{SNSFH} ，并将 \overline{FAULT} 引脚置为有效以作为诊断报告。两个电流限制阈值为：

- 外部可编程电流限制：一个外部电阻器 R_{ILIM} 用于设置通道电流限制。当流经器件的电流超过 I_{CL} (电流限制阈值) 时，闭环立即介入。 V_{GS} 电压相应地进行调节，从而实现 V_{DS} 电压调节。设置闭环后，电流被钳制于设定值。外部可编程电流限制提供了根据应用设置电流限制值的能力。

此外，可以通过更改 $ILIM$ 引脚上的电阻来动态更改该值。这可以在[应用部分](#)中看到。

- 内部电流限制： I_{LIM} 引脚开路或引脚接地短路 -- 如果外部电流限制超出下限或 I_{LIM} 引脚接地短路，则内部电流限制是固定的，通常为 $0.5A$ 。在短路或开路连接以及 PCB 过应力故障期间，这可作为安全功率限制机制。

当 V_S 加电并且 EN 为高电平时，内部电流限制 ($I_{lim,nom}$) 和外部可编程电流限制都始终有效。(I_{LIM} 和外部可编程电流限制的) 较低值用作实际电流限制。电流限制置为有效的典型抗尖峰脉冲时间为 $2.5 \mu s$ 。

请注意，如果使用接地网络 (这会导致器件 GND 和电路板 GND 之间发生电平转换)，则 $ILIM$ 引脚必须与器件 GND 连接。使用[方程式 2](#) 根据所需的典型 I_{CL} 值计算 R_{LIM} 。

$$R_{ILIM} = K_{CL}/I_{CL} \quad (2)$$

此处计算的 R_{ILIM} 值将对应于电流限制的典型值。对于数据表中列出的 R_{ILIM} 值，电气特性表中提供了最小和最大电流限制值。对于介于两者之间的任何 R_{ILIM} 值，可以使用线性内插来估算最小值和最大值。

电气特性表中列出的电流限制的最小值包含 $FAULT$ 置为有效的变化情况。在设计模块以确保在标称运行期间不将 $FAULT$ 信号置为有效时，最小电流限制需要高于标称工作电流。[节 9.2.2.1](#) 中给出了一个示例。

为了更好地防止出现硬接地短路情况 (当 V_S 和输入为高电平，并且突然发生接地短路时)，开环快速响应行为设置为在设置电流限制闭环之前关闭通道。凭借这种快速响应能力，器件可以实现最佳的浪涌抑制性能。

8.5.2.1 短路和过载保护

TPS281C100 提供输出短路保护，以确保器件在接地路径阻抗较低时阻止电流流动，从而消除损坏或严重电源降压的风险。无论 $ILIM$ 引脚的状态如何，该器件都能保证在 $125^{\circ}C$ 下提供高达 $60V$ 的电源，从而防止发生短路事件。

[导通状态短路行为](#)显示了 TPS281C100 在发生短路且器件处于导通状态并已在输出电流时的行为。当内部导通 FET 完全启用时，电流钳位稳定时间会更慢，因此，为了确保过冲受到限制，该器件在电平 I_{OVCR} 下实现快速跳变电平。当达到此快速跳变阈值时，该器件会立即关闭一小段时间，然后快速重新启用，并在短暂的瞬态过冲至更高的峰值电流 (I_{CL_ENPS}) 电平后将电流钳位到 I_{CL} 电平。然后，该器件会将电流保持钳位在稳压电流限制，直到达到热关断温度，而器件将安全关断。

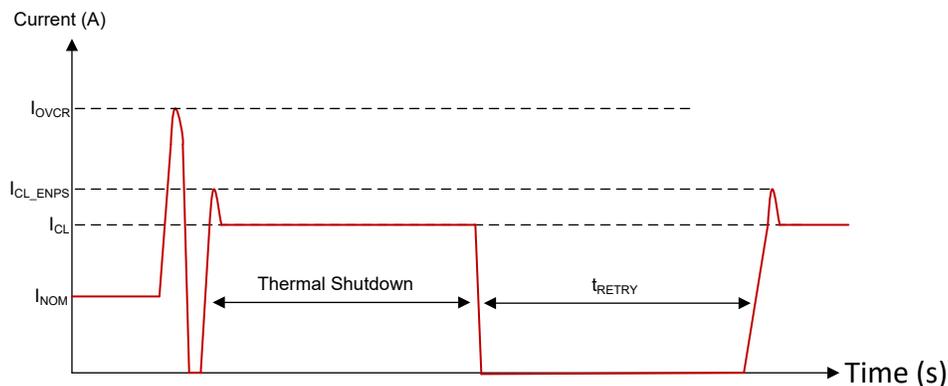


图 8-5. 导通状态短路行为

[过载行为](#)显示了当阻抗发生微小变化导致负载电流高于 I_{CL} 阈值时 TPS281C100 的行为。电流升至高于调节电平的 I_{CL_LINPK} 。然后，电流限制调节环路启动，电流降至 I_{CL} 值。

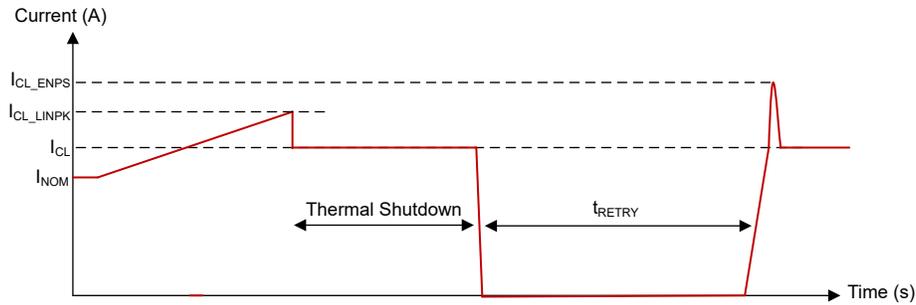


图 8-6. 过载行为

在所有这些情况下，内部热关断是安全的，可以重复执行。反复达到此热关断电平不会带来器件风险或寿命可靠性问题。

8.5.2.2 电容充电

电容充电电路展示了容性负载应用的典型设置，以及使用该器件时运行的内部块。请注意，所有容性负载都有一个与电容器并联的关联“负载”，该负载被描述为电阻负载，但实际上它可以是电感负载或电阻负载。

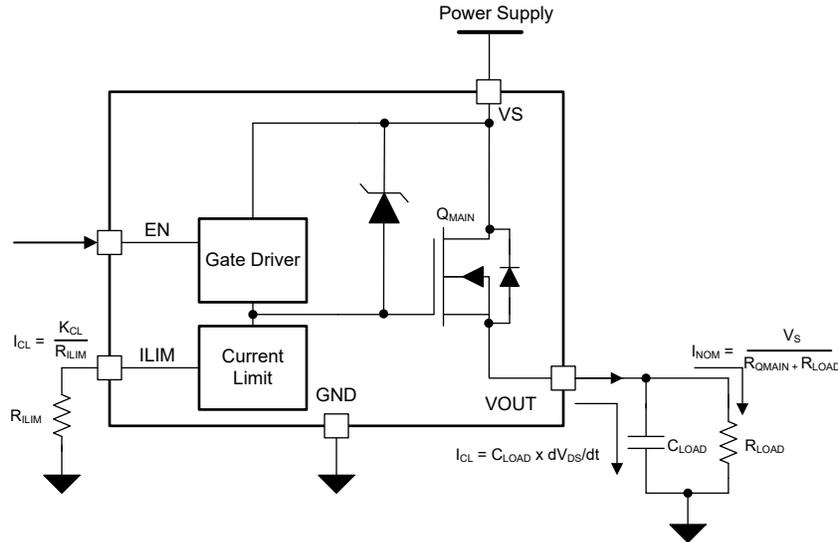


图 8-7. 电容充电电路

首先要检查的是 TPS281C100 器件可以接受标称直流电流 I_{NOM} 。这可以很轻松地完成，方法是从热性能部分获取 $R_{\theta JA}$ ，将 TPS281C100 的 R_{ON} 与其 I_{NOM} 相乘，再加上环境温度，如果该值低于热关断值，则器件可以在该负载电流下运行。有关此计算的示例，请参阅应用部分。

此应用的第二个关键关注点是确保容性负载可以完全充电，而不会使器件发生热关断。这是因为，如果器件在充电期间发生热关断，则与电容器并联的负载的电阻性质将在 TPS281C100 关断期间开始对电容器放电。请注意，有些应用具有足够高的负载阻抗，TPS281C100 发生热关断并重试是可接受的；然而，对于大多数应用，系统设计应确保 TPS281C100 在对电容器充电时不会发生热关断。

借助 TPS281C100 的电流钳位特性，与其他高电流限制开关相比，能够以更低的浪涌电流给电容器充电。这种较低的浪涌电流意味着电容器将需要更长的时间才能完全充电。然而，为了最大限度地减少启动过程中这一较长的充电时间，TPS281C100A 实现了图 8-8 中所述的浪涌电流处理特性。当 EN 引脚变为高电平以开启高侧开关时，器件会将其电流限制阈值默认为 $I_{LIM_STARTUP}$ ，持续时间为 $I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ 。在此延迟期间，容性负载的充电速率可以高于 I_{CL} 典型值所允许的速率，并且将屏蔽 FAULT 以防止不必要的故障触发。在 $I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ 后，电流限制将默认回到 I_{CL} ，故障将正常工作。

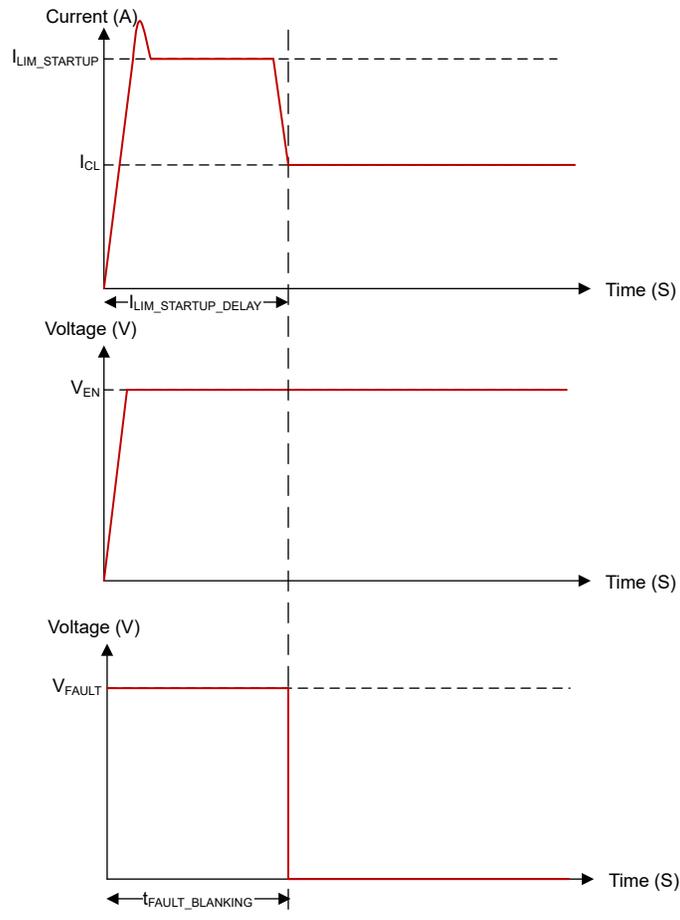


图 8-8. 浪涌电流处理

电流限制较高时的初始浪涌电流周期可在驱动负载时实现两种不同的系统优势：

- 能够在毫秒级的时间段内支持更高的负载电流，以驱动白炽灯泡负载等高浪涌电流负载。
- 能够实现快速容性负载充电。在某些情况下，理想的做法是以高于直流电流的电流为容性负载充电，以确保快速供电。该架构允许模块使用初始较高的浪涌电流限制快速为容性负载充电，然后使用较低的电流限制在过载或短路条件下可靠地保护模块。

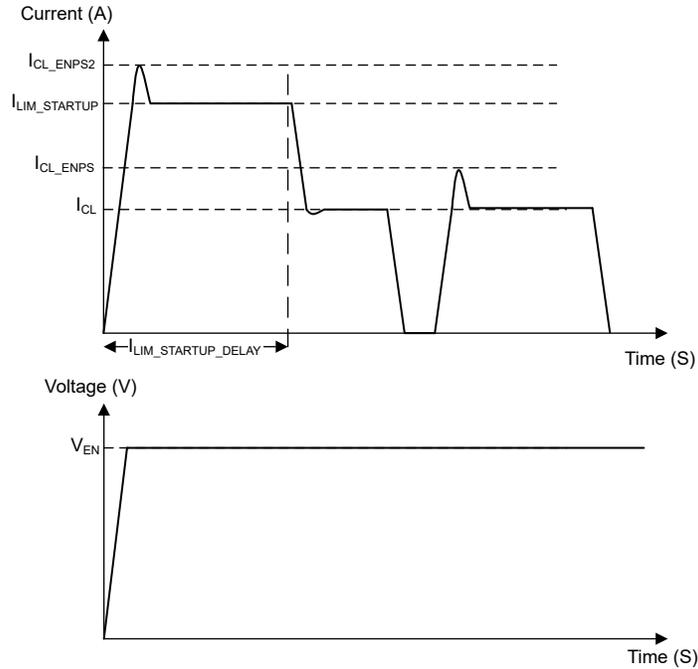


图 8-9. $I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ 之前的自动重试行为

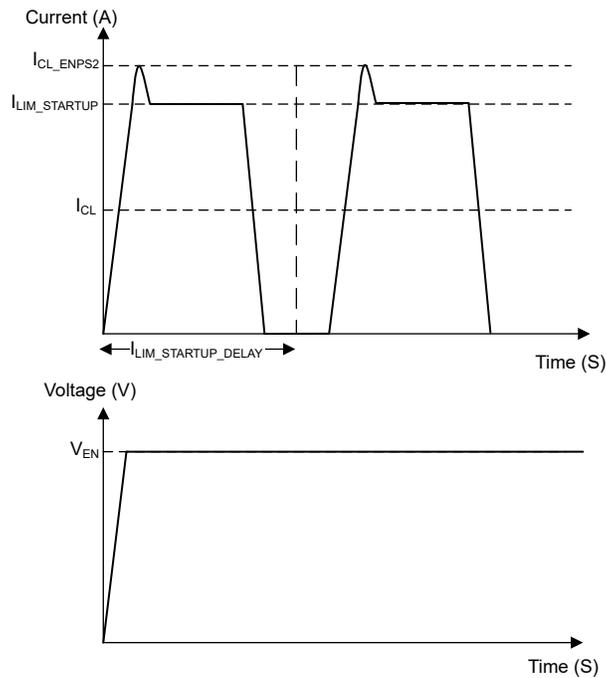


图 8-10. $I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ 之后的自动重试行为

在电流限制模式下，在任何电平下，器件都将具有较高的功率耗散。如果 FET 温度超过过热关断阈值，器件将仅关闭过载的通道。冷却后，器件将重试。如果器件在启动时过早关闭，建议改进 PCB 热布局、降低电流限制以降低功率耗散，或者减少浪涌电流（容性负载）。

有关使用高侧开关进行电容充电的更多信息，请参阅[如何驱动容性负载](#)应用手册。本应用手册包含有关可用热建模的信息，以及估算高侧开关是否能够将电容器充电至给定电压的快速方法。

8.5.3 电感负载关断钳位

当关断电感负载时，由于电感特性，输出电压下拉至负值。如果在电流衰减期间没有对电压进行钳位，则功率 FET 可能会击穿。在这种情况下，为了保护功率 FET，请在内部钳制漏源电压，即 $V_{DS,clamp}$ （漏极和栅极之间的钳位二极管）。

$$V_{DS,clamp} = V_S - V_{OUT} \tag{3}$$

在电流衰减期间 (T_{DECAY})，功率 FET 导通以进行电感能量耗散。电源 (E_S) 和负载 (E_{LOAD}) 的能量都消耗在高侧电源开关本身上，称为 E_{HSD} 。如果电阻与电感串联，则部分负载能量会在电阻中耗散。

$$E_{HSD} = E_S + E_{LOAD} = E_S + E_L - E_R \tag{4}$$

从高侧电源开关的角度来看， E_{HSD} 等于电流衰减期间的积分值。

$$E_{HSD} = \int_0^{T_{DECAY}} V_{DS,clamp} \times I_{OUT}(t) dt \tag{5}$$

$$T_{DECAY} = \frac{L}{R} \times \ln\left(\frac{R \times I_{OUT(MAX)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|}\right) \tag{6}$$

$$E_{HSD} = L \times \frac{V_{BAT} + |V_{OUT}|}{R^2} \times \left[R \times I_{OUT(MAX)} - |V_{OUT}| \ln\left(\frac{R \times I_{OUT(MAX)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|}\right) \right] \tag{7}$$

当 R 大概等于 0 时， E_{HSD} 可以简单地表示为：

$$E_{HSD} = \frac{1}{2} \times L \times I_{OUT(MAX)}^2 \frac{V_{BAT} + |V_{OUT}|}{R^2} \tag{8}$$

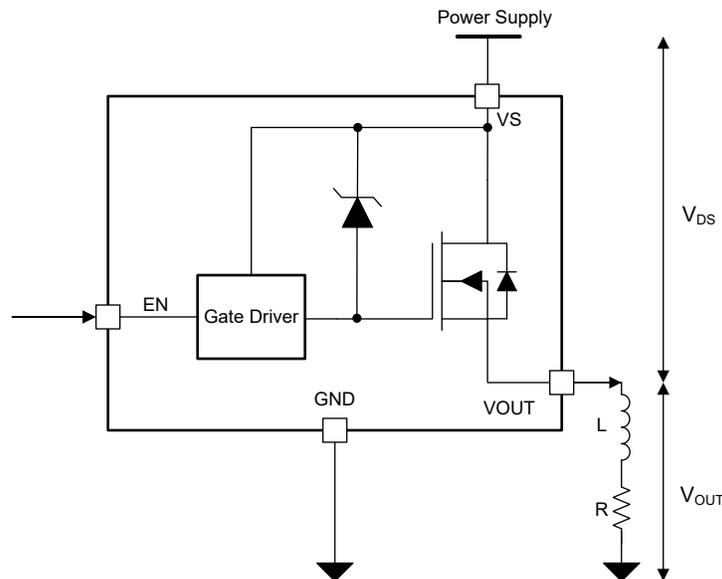


图 8-11. 驱动电感负载

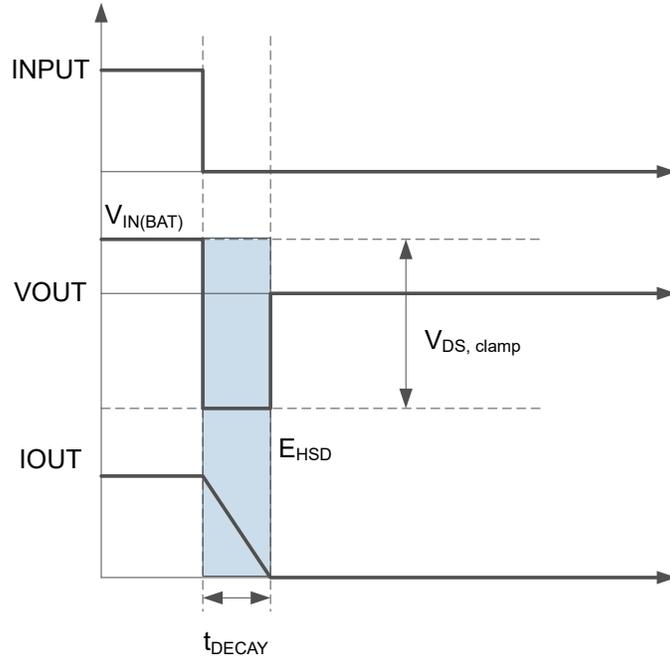


图 8-12. 电感负载关断图

如前所述，关断时，电池能量和负载能量会在高侧电源开关上耗散，这会导致热变化较大。对于每个高侧电源开关，最大安全功率耗散的上限取决于器件的固有容量、环境温度和电路板功耗条件。

8.5.4 电感负载消磁

关闭电感负载时，电感器可以在开关的输出端施加负电压。TPS281C100 在 VS 和 VOUT 之间包含电压钳位，以限制 FET 两端的电压并对负载电感（如果有）进行消磁。施加在 OUT 引脚上的负电压驱动电感器电流的放电。

图 8-13 展示了器件对 400mH 负载进行放电的情况。

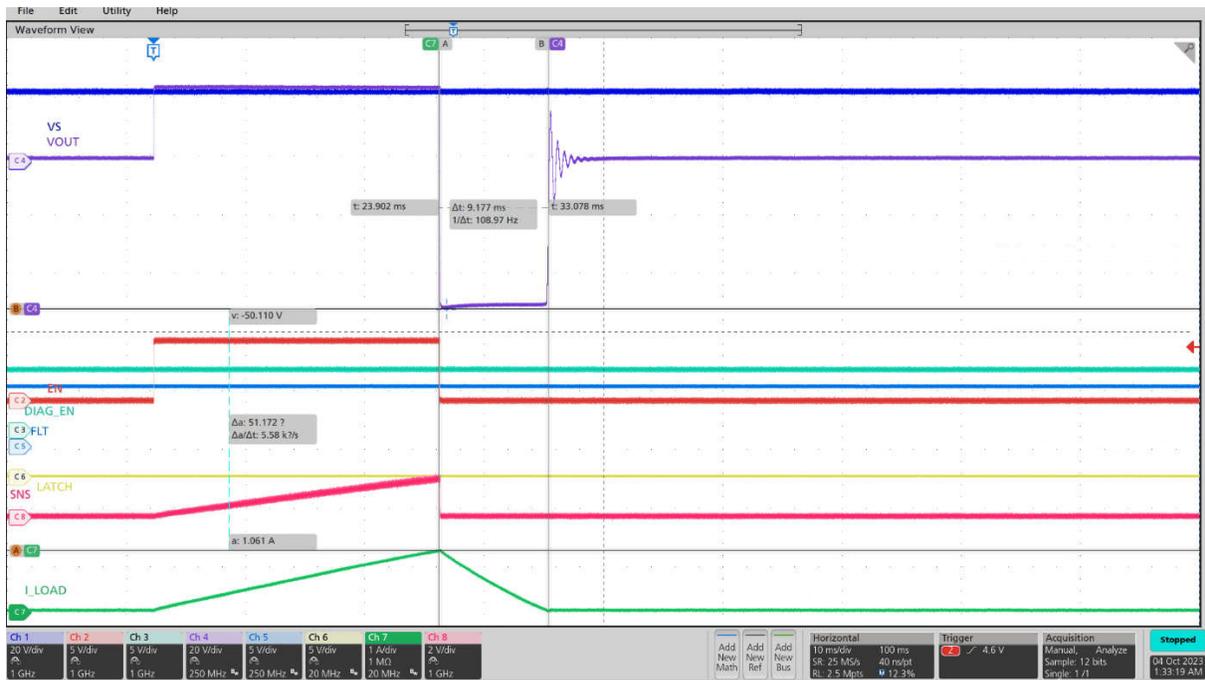


图 8-13. TPS281C100 电感放电 (400mH)

可接受的最大负载电感是器件中耗散的能量的函数，因此也是负载电流和电感负载的函数。器件在 125°C 下对于一次脉冲电感耗散所能承受的最大能量和负载电感如图 8-14 所示。对于具有 2Hz 重复脉冲的 100 万个电感重复脉冲，该器件可以承受该能量的 40%。如果应用参数超出该器件限制，请使用续流二极管之类的保护器件来耗散存储在电感器中的能量。

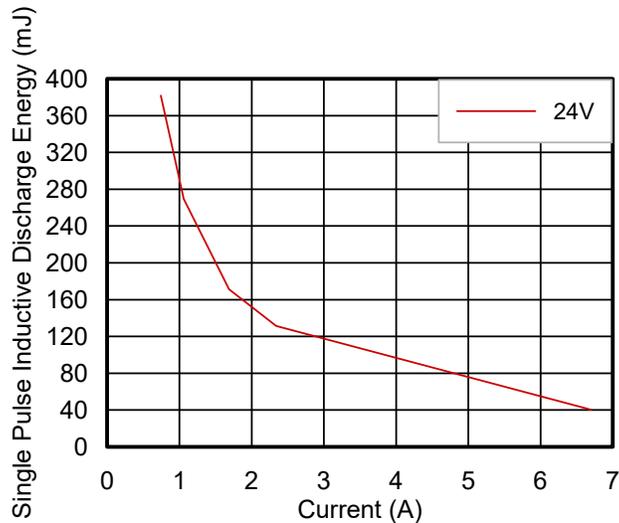


图 8-14. TPS281C100 在 125°C 和 24V 电源条件下的电感负载放电能量能力

8.5.5 全面保护和诊断

当 DIAG_EN 启用时，[电流检测](#)处于活动状态。当 DIAG_EN 为低电平时，禁用电流检测。SNS 输出处于高阻抗模式。

表 8-2. DIAG_EN 逻辑表

DIAG_EN	EN 条件	保护和诊断
高电平	高电平	请参阅故障表
	低电平	
低电平	高电平	诊断已禁用且 SNS 输出设置为高阻抗。
	低电平	保护是正常的， $\overline{\text{FAULT}}$ 继续指示 TSD 或 ILIM。

表 8-3. 状态表 (DIAG_EN=高电平)

工作条件	EN	VOUT	OL_ON	FAULT	SNS	行为	恢复
正常 标准检测	低电平	低电平	低电平	高阻态	0	正常	
	高电平	高电平	低电平	高阻态	I_{Load}/K_{SNS}	正常	
高精度检测 无效范围	高电平	高电平	高电平	低电平	I_{Load}/K_{SNS}	FAULT 置为有效表明由于 $I_{Load} > I_{K_{SNS2_EN}}$ 而未启用高精度检测	当负载降低至低于 $I_{K_{SNS2_EN}}$ 或 OL_ON 复位至 LO 时清除。
高精度检测 正常运行	高电平	高电平	高电平	高阻态	I_{Load}/K_{SNS2}	启用 K_{SNS2} 检测比以实现高精度检测，由于满足有效条件 $I_{Load} < I_{K_{SNS2_EN}}$ ，因此 FAULT 保持高阻抗。	
过流	高电平	$V_S - I_{LIM} * R_{LOAD}$	x	低电平	V_{SNSFH}	将电流保持为电流限制，直至热关断	
STG、相对热关断、绝对热关断	高电平	高/低电平	x	低电平	V_{SNSFH}	当器件达到相对或绝对热关断时关断	当 T_{HYS} 得到满足且持续时间长于 t_{RETRY} 时间量时自动重试
负载开路	高电平	高电平	低电平	高阻态	$I_{Load}/K_{SNS} = \sim 0$	正常行为，用户可以判断是否为开路负载	
	高电平	高电平	高电平	高阻态	$I_{Load}/K_{SNS2} = \sim 0$	正常行为，用户可以判断是否为开路负载	
	低电平	高电平	低电平	低电平	V_{SNSFH}	内部上拉电阻有效。如果 $V_S - V_{OUT} < V_{OL}$ ，则故障激活	当故障消失时清除
反极性	x	x	x	x	x	通道将开启以降低功率耗散。流入接地引脚的电流受外部接地网络的限制	

8.5.5.1 开路负载检测

导通状态开路负载检测

当启用主通道时，通过读取 SNS 或 \overline{FLT} 引脚上的电压来诊断故障，并由用户判断。高精度电流检测的一个好处是：该器件可以实现非常低的开路负载检测阈值，从而相应地扩大正常工作区域。如高精度检测模式部分所述，此模式可用于准确地检测低电流。

关断状态开路负载检测

在关断状态下，如果连接了负载，则输出电压拉至 0V。在开路负载的情况下，输出电压接近电源电压 $V_S - V_{OUT} < V_{OL,off}$ 。FLT 引脚变为低电平以向 MCU 指示故障，SNS 引脚上拉至 I_{SNSFH} 。由于内部逻辑控制路径或外部湿度、腐蚀等原因，输出端始终存在漏电流 $I_{ol,off}$ 。这样，TI 实现了一个内部上拉电阻来抵消漏电流。此上拉电流应小于输出负载电流，以避免在正常运行模式下产生误检测。为了降低待机电流，TI 实现了一个与由 DIAG_EN 引脚控制的上拉电阻串联的开关。上拉电阻值为 R_{OL_OFF} 。

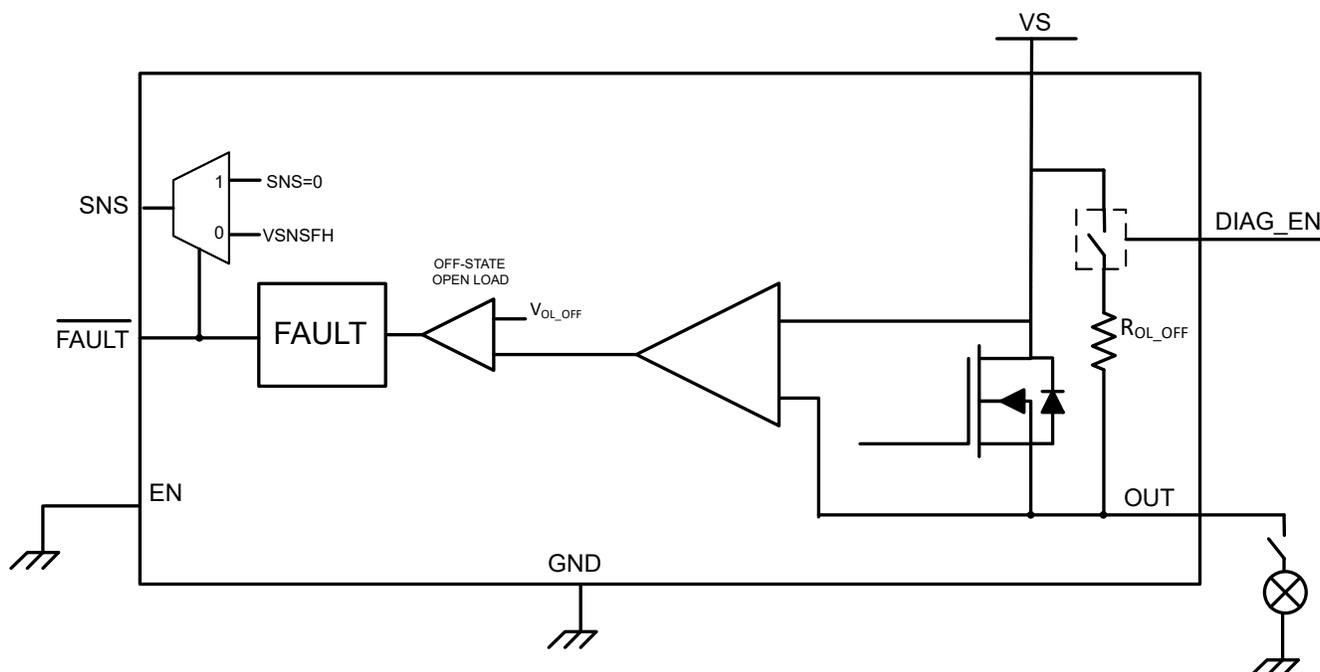


图 8-15. 关断状态开路负载检测电路

8.5.5.2 热保护行为

热保护行为可分为两类可能发生的事件。[热行为](#)显示了其中的每个类别。

1. **相对热关断**：启用该器件以进入过流事件。DIAG_EN 引脚处于高电平，以便可以在 SNS 和 FLT 上监控诊断。输出电流升至高达 I_{LIM} 电平，FLT 变为低电平，同时 SNS 变为 V_{SNSFH} 。随着这一大量电流流过，FET 的结温相对于控制器温度迅速升高。当功率 FET 温度升高的 T_{REL} 量超过控制器结温 $\Delta T = T_{FET} - T_{CON} > T_{REL}$ 时，器件关断。SNS 和 FLT 上会持续显示故障，而器件等待 t_{RETRY} 计时器到期。当 t_{RETRY} 计时器到期时，由于 EN 仍然为高电平，器件将重新进入此 I_{LIM} 状况。
2. **绝对热关断**：在这种情况下，环境温度现在比前一种情况要高得多。在 DIAG_EN 为高电平的过流事件中，器件仍处于启用状态。然而，在这种情况下，结温升高并达到绝对参考温度 T_{ABS} ，然后关断。直到 $T_J < T_{ABS} - T_{hys}$ 且 t_{RETRY} 计时器到期，器件才会恢复。

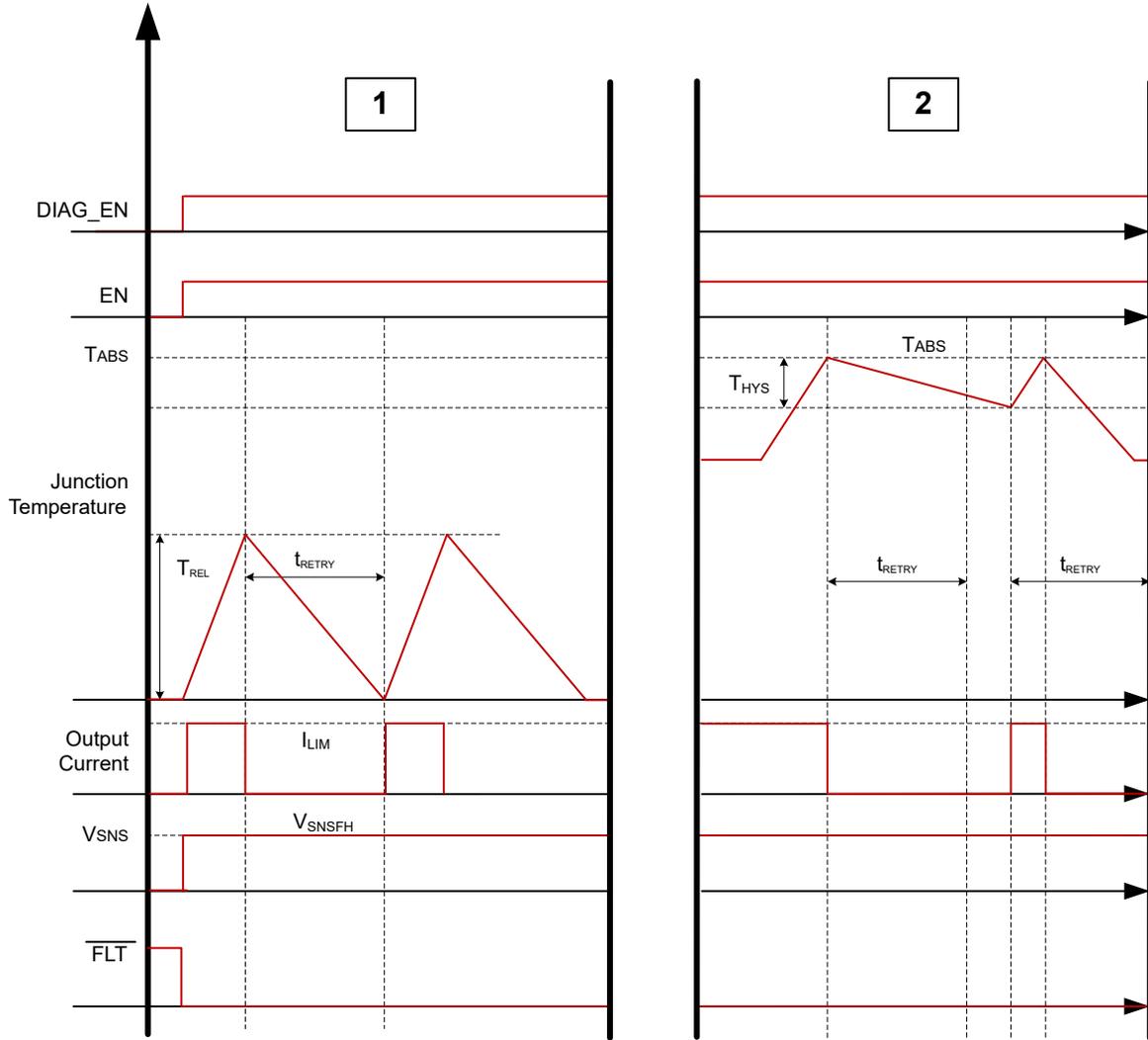


图 8-16. 热行为

8.5.5.3 欠压闭锁 (UVLO) 保护

该器件可监控电源电压 V_S ，以防止电源电压过低时出现意外行为。当电源电压降至 V_{UVLOF} 时，输出级自动关断。当电源电压升至 V_{UVLOR} 时，器件将导通。如果过流事件触发 UVLO 阈值，器件将关断并安全地恢复到电流限制状态。

8.5.5.4 反极性保护

方法 1 : 阻断二极管与 VBB 相连。极性相反时，器件和负载均受到保护。在电池反向条件下，阻断二极管不允许任何电流流动。

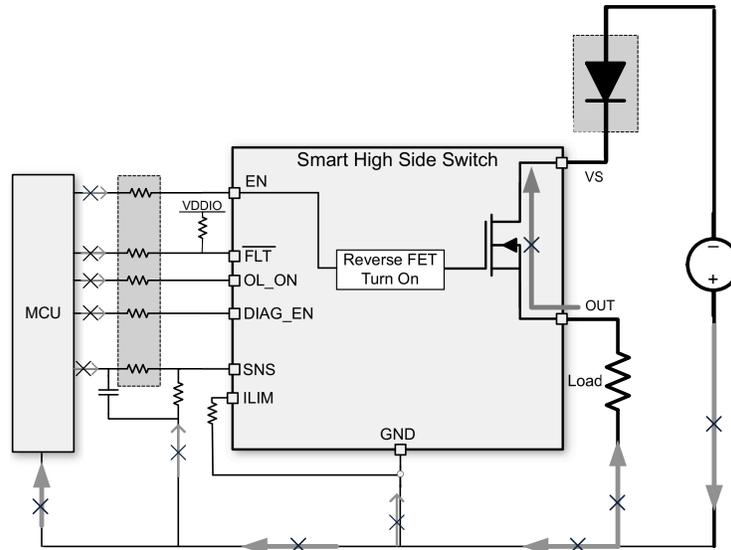


图 8-17. 采用阻断二极管实现反向保护

方法 2 (接地网络保护)：在此连接下，只有高侧器件受到保护。负载反向环路受负载本身的限制。注意，当发生反极性时，通过功率 FET 的持续反向电流应小于 I_{rev} 。在这三种类型的接地引脚网络中，TI 强烈建议使用 3 类 (电阻器和二极管并联)。无论器件 GND 和电路板 GND 之间采用何种连接类型，如果发生 GND 电压偏移，请确保以下连接正确才能正常运行：

- 将 NC 引脚悬空或连接到器件 GND。TI 建议保持悬空。
- 将电流限制可编程电阻器连接到器件 GND。

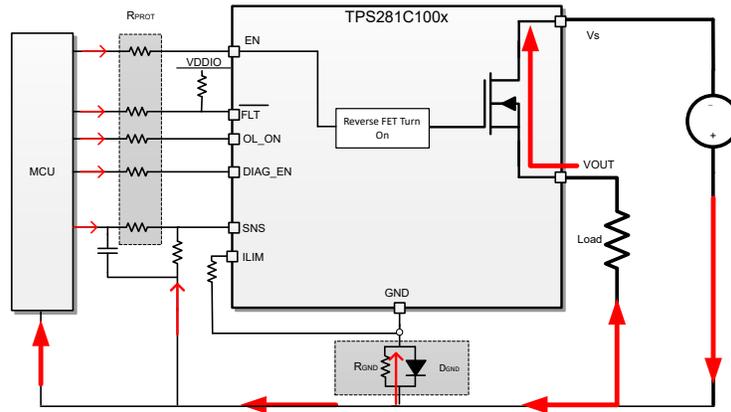


图 8-18. 通过接地网络实现反向保护

- **1 类 (电阻器)：**当电池反向或 ISO 脉冲为负时，电阻值越高，电流限制效果越好。然而，在正常操作模式期间，它会导致更高的 GND 偏移。另外，还要考虑电阻器的功率耗散。

$$R_{GND} \leq \frac{V_{GNDshift}}{I_{nom}} \quad (9)$$

$$R_{GND} \geq \frac{(-V_{CC})}{(-I_{GND})} \quad (10)$$

其中

- $V_{GNDshift}$ 是 GND 偏移的最大值，由 HSS 和微控制器确定。TI 建议采用 $\leq 0.6V$ 的值。
- I_{nom} 是标称工作电流。
- $-V_{CC}$ 是电池线路上的最大反向电压。
- $-I_{GND}$ 是接地引脚可以承受的最大反向电流，可在 [节 6.1](#) 中找到。

如果使用多个高侧电源开关，则可以在多个器件间共享电阻器。

- **2 类 (二极管)：**需要一个二极管来阻止反向电压，这也会带来接地偏移 (约 600mV)。然而，为了避免在关闭时出现异常状态，电感负载不可接受。
- **3 类 (电阻器和二极管并联, 推荐)：**当电感负载关闭时，可能会出现峰值负尖峰，这可能会损坏 HSD 或二极管。因此，TI 建议在驱动电感负载时将电阻器与二极管并联。建议选择与 $I_F > 100mA$ 的二极管并联的 $4.7k\Omega$ 电阻器。如果使用多个高侧开关，则可以在器件间共享电阻器和二极管。

8.5.5.5 MCU I/O 保护

在许多情况下，如负浪涌脉冲或电感负载导致的电池损失，器件 GND 引脚上的负电位可能会损坏 MCU I/O 引脚 [更有可能损坏连接到引脚的内部电路]。因此，需要在 MCU 和 HSS 之间连接串联电阻。

此外，为了防止接地丢失，TI 建议对 RPROT 电阻器为 $10k\Omega$ 。

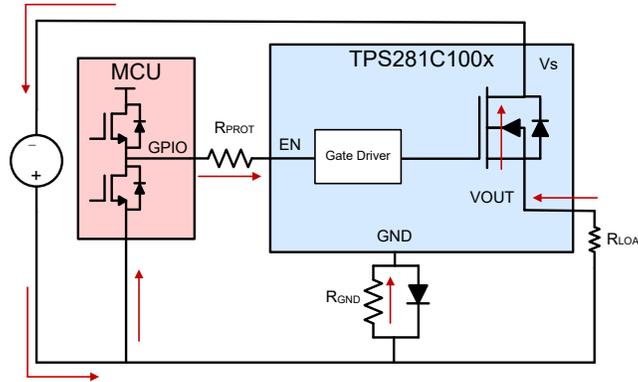


图 8-19. MCU IO 保护

8.5.5.6 诊断使能功能

诊断使能引脚 **DIAG_EN** 通过在多个器件间共享相同的检测电阻和 ADC 线路或 I/O 端口，为电流检测或数字状态提供微控制器诊断输入的多路复用。

此外，该引脚可用于管理器件的功率耗散。在输出端导通期间，如果不需要连续检测输出诊断，诊断禁用特性将降低工作电流。另一方面，在输出端关断期间，诊断禁用功能可降低待机条件下的电流消耗。

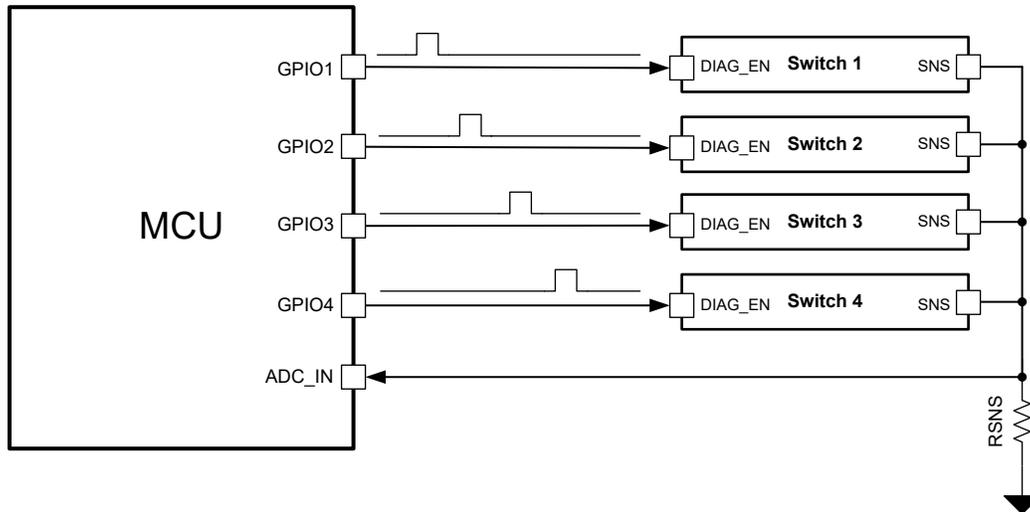


图 8-20. 电阻器共享

8.5.5.7 接地丢失

接地连接可能会在器件级或模块级丢失。如果接地连接丢失且电源电压低于 48V，则无论 **EN** 输入电平如何，通道输出都将被禁用。如果在接地连接丢失时开关已被禁用，则即使通道已启用，输出也将保持禁用状态。从输出端到保持连接到系统地的负载的稳态电流低于在本文档的 **规格** 部分中指定的电平。重新连接接地后，将恢复正常运行。

9 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

9.1 应用信息

9.2 典型应用

典型应用电路显示了一个有关如何设计外部电路参数的示例。

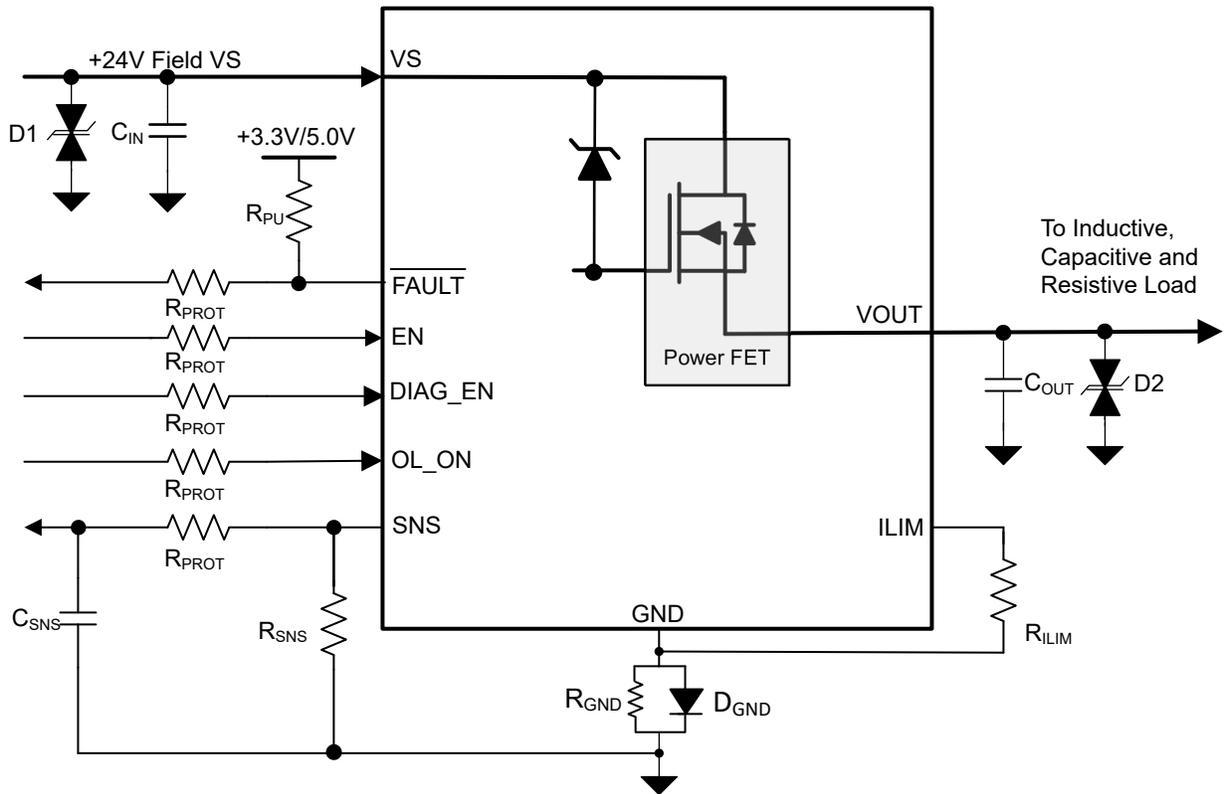


图 9-1. 典型应用电路

9.2.1 设计要求

元件	典型值	用途
D1	SMBJ36A	钳制电源输入端的浪涌电压。如果需要电涌保护，则为必需。请参阅节 9.2.1.2。
D2	SMBJ33CA	钳制电源输出端的浪涌电压。如果需要电涌保护，则为必需。请参阅节 9.2.1.2。
CIN1	100nF	稳定输入电源并滤除低频噪声。
CIN2	4.7nF	过滤电压瞬态（例如，ESD、IEC 61000-4-5）并改善辐射性能。
RPROT	10k Ω	微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器 - 对于反极性保护为可选的
RILIM	10k Ω - 50k Ω	设置电流限制阈值
RSNS	1k Ω	将检测电流转换为检测电压。
CSNS	1nF	与 SNS 线路上的 RPROT 耦合会生成一个低通滤波器，以滤除进入 MCU 的 ADC 的噪声。
CVOUT	22nF	改善 EMI 性能，过滤电压瞬态
RGND	4.7k Ω	稳定在关闭电感负载期间的 GND 电位 - 对于反极性保护为可选的
DGND	BAS21 二极管	在正常运行期间使 GND 保持接近系统地 - 对于反极性保护为可选的

9.2.1.1 IEC 61000-4-4 EFT

TPS281C100 设计为以最小 22nF 的输出电容耐受 IEC 61000-4-4 电气快速瞬态 (EFT)。此器件可在 VS 和 VOUT 端口上通过 ± 2 kV EFT。当 EN 为低电平时，器件将在 EFT 脉冲期间保持关断状态，并在此脉冲之后正常工作。当 EN 为高电平时，器件将耐受脉冲，随后正常工作。

为了在关断状态下进行有源 EFT 检测，TPS281C100 在关断状态下使检测电路处于有源状态。与其他高侧开关中常规的关断电流相比，它会引入更高的关断状态电流 $I_{IDLE, VS}$ 或 I_{IDLE, VS_DIAG} 。

此外，当 DIAG_EN 为低电平时，器件在输出端启用灌电流，该灌电流可以在输出端灌入高达 $I_{OUT(OFF, SINK)}$ 的电流。这有助于抵消器件在 EFT 期间的任何漏电流，并在关断状态和 EFT 事件期间使输出电压保持接近 0V。当 DIAG_EN 为高电平时，存在关断状态上拉电阻，用于将输出电压上拉至接近 VS。在这种情况下，输出灌电流未激活。

9.2.1.2 IEC 61000-4-5 浪涌

为了通过 TPS281C100 的 IEC61000-4-5 浪涌，需要输入和输出 TVS 二极管来帮助吸收浪涌能量。下面列出了对输入和输出 TVS 二极管选择的某些要求。

输出 TVS 要求：

输出 TVS 有两个用途：吸收输出浪涌的浪涌能量，并在电感关断期间帮助对电感能量进行消磁。为确保在输出浪涌事件期间，在内部 VDS 钳位发生之前，输出 TVS 发生钳位，需要选择 TVS 的钳位电压，以便 $VS + V_{TVS, CLMAP} < V_{DS, Clamp, min}$ 。对于标准 24V 输入系统，建议在输出端使用 **SMBJ33CA**。

输入 TVS 要求：

需要选择输入 TVS，使其不会干扰正常运行。输入 TVS 的反向关断电压需要大于正常运行输入电压。另一个要求是输入 TVS 的额定电压需要等于或高于输出 TVS 的额定电压，并确保当出现输出浪涌时，浪涌能量被输出 TVS 钳位，而不是被输入 TVS 钳位。对于标准 24V 输入系统，建议在输入端使用 **SMBJ36A**。请注意，需要在输入端使用单向 TVS，这样就不会在出现负输入浪涌时违反器件的绝对最小电压。

9.2.2 详细设计过程

9.2.2.1 选择 R_{LIM}

TPS281C100 的电流限制设置电平必须允许最大直流电流并留有余量，但在故障情况下，通过尽可能地减小电流限制，来更大幅度地减少开关中的能量和输入电源上的负载。

设置标称电流限制时，应确保最坏情况（最低）电流限制高于最大标称负载电流。如果应用是 500mA 数字输出模块，最大电流为 1A，则可以通过两种方法来设置电流限制。

第一种方法是使用电气特性表中列出的电阻值。25kΩ R_{LIM} 电阻器设置将电流限制最小电平设定为 1.5A，该值高于最大标称负载电流。如果应用中可以接受设置的高端值 2.3A，则可以使用 25kΩ 的 R_{LIM} 电阻。

如果应用想要尽可能地减小模块看到的最大电流，则需要选择电流限制电阻器，以使最小电流限制电平尽可能接近最大负载电流。为了获得 1A 的最小电流限制，需要按相同的比例缩放典型电流限制： $1 \times 1.32 = 1.32A$ 。通过线性插值，我们可以发现在 1.32A 典型电流限制下的 K_{CL} 值为 48.5A * kΩ。

$$R_{LIM} = K_{CL} / I_{CL} \quad (11)$$

计算出的 R_{LIM} 值为 36.7kΩ，最接近的 1% 标准电阻值为 36.5kΩ。

9.2.2.2 选择 R_{SNS}

表 9-1 展示了此应用中负载电流检测的要求。K_{SNS} 值是为器件指定的，可以在 [规格](#) 部分中找到。

表 9-1. R_{SNS} 计算参数

参数	示例值
电流检测比 (K _{SNS1})	800
电流检测比 (K _{SNS2})	24
最大可诊断负载电流	3A
最小可诊断负载电流	4mA
满量程 ADC 电压	5.0V
ADC 分辨率	10 位

高达 3A 的负载电流测量可确保即使在发生过载但仍低于设定电流限制的情况下，MCU 也可以通过关断 FET 进行寄存和反应，同时 4mA 的低电平允许精确测量低负载电流，并能够将开路负载故障与支持的标称负载电流区分开来。对于负载电流 < 50mA，客户可以启用高精度检测，以将检测比从 K_{SNS1} 更改为 K_{SNS2}。这防止了对更高分辨率 ADC 的要求，并且还提高了检测精度。有关更多信息，请参阅[高精度检测](#)。

选择的 R_{SNS} 电阻值应使得最大可诊断负载电流将 SNS 引脚电压 (V_{SNS}) 置于大约为 ADC 满量程的 90%。对于此设计，任何高于满量程 (FS) 80% 的 ADC 值都可视为故障。此外，R_{SNS} 电阻值应确保最小可诊断负载电流不会导致 V_{SNS} 降至低于 ADC 的至少几个 LSB。

对于给定的示例值，1.0kΩ 检测电阻可以满足这两个要求。

表 9-2. V_{SNS} 计算

检测模式	OL_ON	负载 (A)	检测比	I _{SNS} (mA)	R _{SNS} (Ω)	V _{SNS} (V)	5V ADC 的百分比
标准检测	LO	3A	800	3.75	1000	3.75	75%
高精度检测	HI	0.004 A	24	0.166	1000	0.166	3.3% (~34LSB)

9.3 电源相关建议

TPS281C100 器件设计为在 24V 工业系统中运行。允许的电源电压范围 (VS 引脚) 为 6V 至 60V (在 VS 引脚处以器件的 GND 引脚为基准测得)。在此范围内，器件满足节 6.5 表中列出的完整参数规格。该器件还设计为承受超出该范围的电压瞬态，例如 SELV 电源故障。

建议在 V_S 电源输入端放置一个 $0.1\mu\text{F}$ 电容器，以稳定输入电源并滤除低频噪声。电源必须能够承受所有瞬态负载电流阶跃。在电源对大瞬态电流或大负载电流阶跃响应缓慢的情况下，输入端可能需要额外的大容量电容。

9.4 布局

9.4.1 布局指南

为了防止热关断， T_J 必须低于 125°C 。如果输出电流非常高，功率耗散可能会很大。HTSSOP 和 WSON 封装具有良好的热阻抗。然而，PCB 布局非常重要。良好的 PCB 设计可以优化热传递，这对于器件的长期可靠性至关重要。

- 尽可能地增大 PCB 上的覆铜，以提高电路板的导热性。从封装到环境的主要热流路径会通过 PCB 上的覆铜。当与封装相对的电路板另一侧的 PCB 上没有连接任何散热器时，尽可能地增加覆铜面积其重要。
- 在封装接地焊盘正下方添加尽可能多的散热过孔，以优化电路板的导热性。
- 所有散热过孔都应在电路板的两侧进行电镀闭合或者堵塞并加盖，以防止出现焊料空洞。为了确保可靠性和性能，焊接覆盖面积应至少为 85%。

9.4.1.1 EMC 注意事项

9.4.2 布局示例

9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局

在不采用接地网络的情况下，将散热焊盘直接连接到电路板上的 GND 覆铜区，以获得更好的热性能。

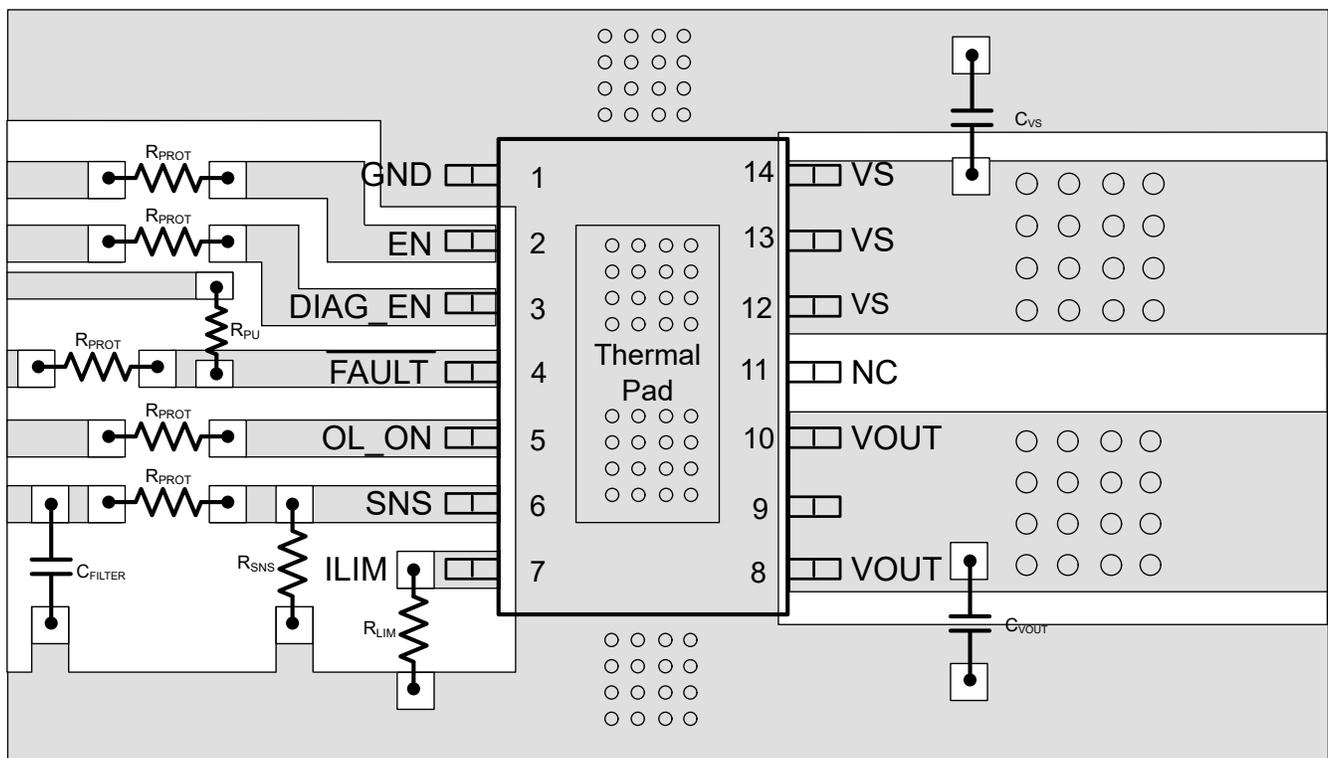


图 9-2. 不采用接地网络的 PWP 布局

9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局

采用接地网络，用一条迹线将散热焊盘穿过接地网络连接到电路板的 GND 覆铜区。

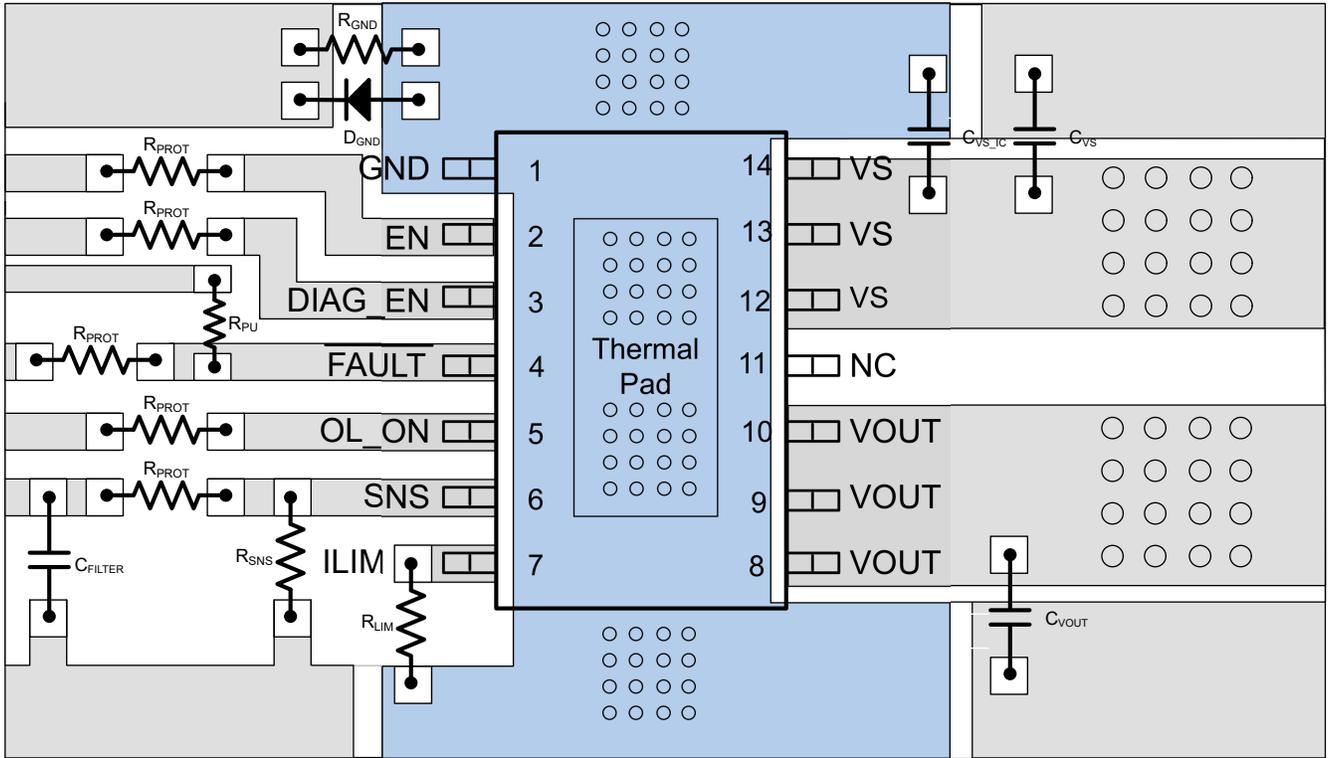


图 9-3. 采用接地网络的 PWP 布局

9.4.2.3 不采用接地网络的 DNT 布局

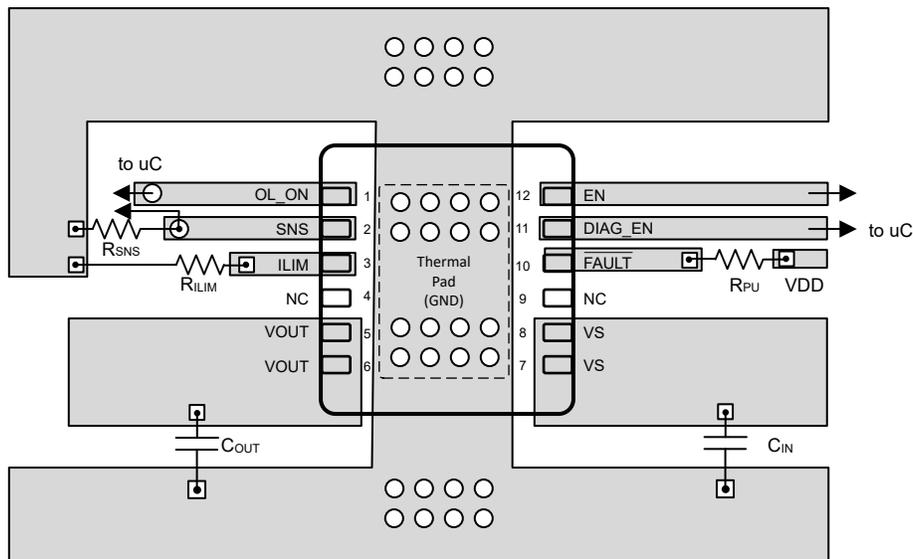


图 9-4. 不采用接地网络的 DNT 布局

9.4.3 散热注意事项

该器件具有热关断 (TABS) 电路，可防止过热。为了实现持续正常运行，结温不应超过热关断跳变点。如果结温超过热关断跳变点，输出将关闭。当结温下降到低于热关断跳变点时，输出会再次导通。

器件耗散的功率根据 [方程式 12](#) 进行计算。

$$P_T = I_{OUT}^2 \times R_{DS(on)} + V_S \times I_{NOM} \quad (12)$$

其中

- P_T = 器件的总功率耗散

在确定器件耗散的功率后，可根据环境温度和器件热阻抗计算结温。

$$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P_T \quad (13)$$

如需更多信息，请参阅[如何驱动电阻、电感、容性和照明负载](#)。

10 器件和文档支持

10.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	说明
December 2023	*	初始发行版

12 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS281C100ADNTR	ACTIVE	WSO	DNT	12	5000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	281C0	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSELETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

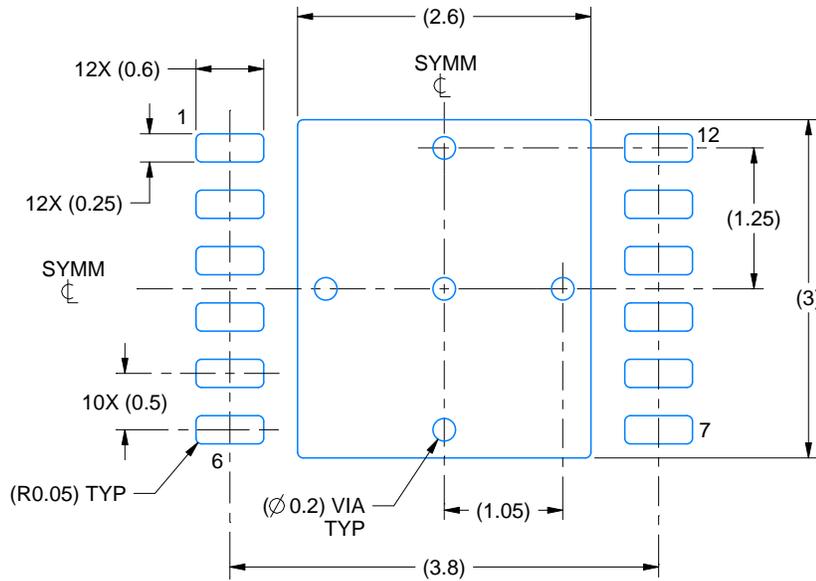
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

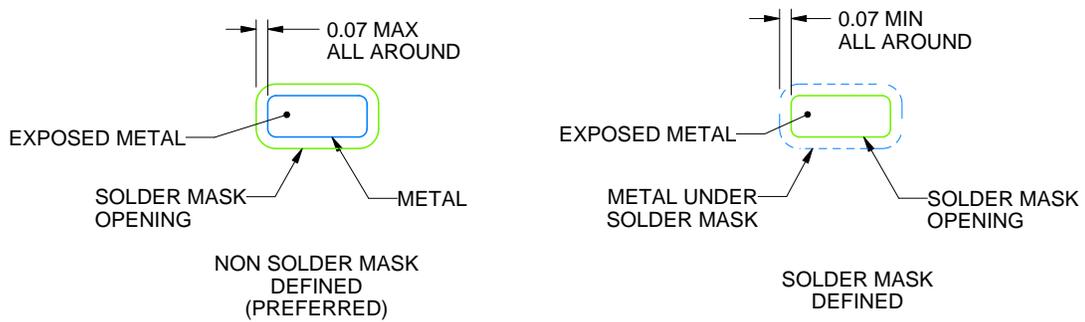
DNT0012B

WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214928/C 10/2021

NOTES: (continued)

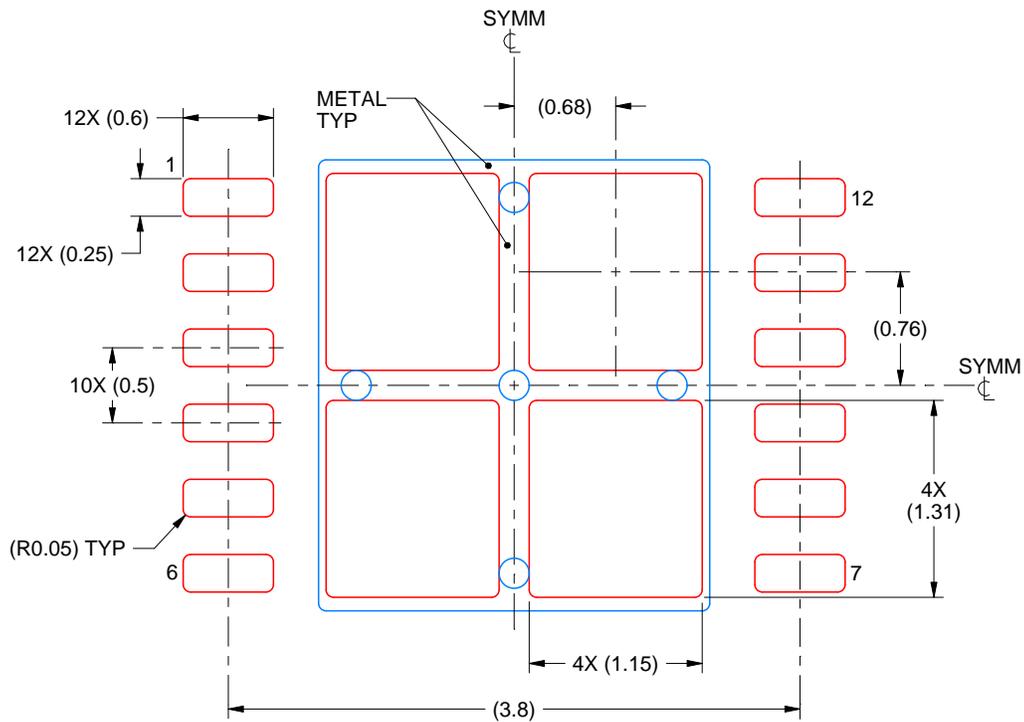
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DNT0012B

WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
77% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:20X

4214928/C 10/2021

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司